

**2026年3月期第1四半期(2025年4月～6月)
決算説明資料**

2025年8月7日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるかと認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2026年3月期第1四半期連結決算概要

2026年3月期第1四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に設備投資が高水準で推移。NAND向け設備投資は再開。民生電子機器向けの需要回復は遅れ、自動車・産業機器向けの需要は軟調。
- 当社1Qは、前年同期に集中した中国地場向けの装置販売が平常化し、前年同期比で減収減益。先端デバイス向け装置販売・改造は好調。

2026年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 一部の半導体デバイスメーカーが設備投資の端境期を迎えているものの、先端デバイスの世代交代に向けた設備投資は今後も続く見通し。
- 上期は概ね計画通りに推移する見通し。下期には装置販売を中心に売上が伸長する見通しで、通期業績予想に変更なし。

連結業績サマリー

下期偏重の当期売上・利益計画に沿って、1Qは前年同期比・直前四半期比で減収減益。
 利益率も上期<下期を計画する中、1Qの売上総利益率は概ね計画通り、前期通期実績を上回る水準。

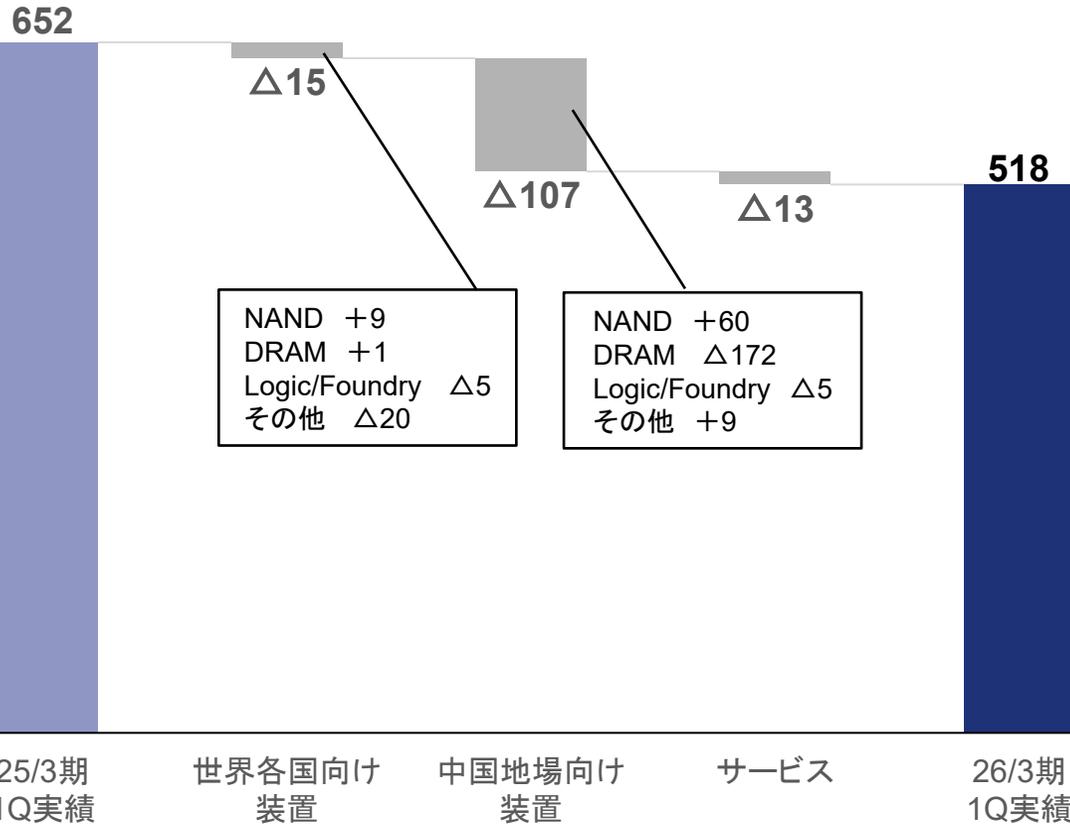
| (億円) | 25/3期 | | | | | 26/3期 | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q | 前年同期比 | 前四半期比 |
| 売上収益 | 652 | 493 | 601 | 643 | 2,389 | 518 | △20.6% | △19.4% |
| 売上総利益 | 294 | 220 | 249 | 255 | 1,017 | 222 | △24.3% | △12.9% |
| 売上総利益率 | 45.0% | 44.6% | 41.4% | 39.7% | 42.6% | 42.9% | △2.1pts | +3.2pts |
| 調整後営業利益 | 194 | 113 | 139 | 132 | 578 | 109 | △43.8% | △17.4% |
| 調整後営業利益率 | 29.7% | 22.9% | 23.1% | 20.5% | 24.2% | 21.1% | △8.6pts | +0.6pts |
| 調整後当期(四半期)利益 | 143 | 73 | 96 | 111 | 423 | 76 | △47.0% | △31.2% |
| 調整後当期(四半期)利益率 | 22.0% | 14.7% | 16.0% | 17.2% | 17.7% | 14.7% | △7.3pts | △2.5pts |
| 営業利益 | 179 | 96 | 123 | 116 | 513 | 97 | △45.6% | △16.3% |
| 営業利益率 | 27.4% | 19.4% | 20.4% | 18.1% | 21.5% | 18.8% | △8.6pts | +0.7pts |
| 税引前当期(四半期)利益 | 177 | 102 | 112 | 116 | 508 | 93 | △47.5% | △19.7% |
| 税引前当期(四半期)利益率 | 27.2% | 20.7% | 18.7% | 18.1% | 21.3% | 18.0% | △9.2pts | △0.1pts |
| 当期(四半期)利益 | 133 | 48 | 80 | 99 | 360 | 68 | △49.1% | △31.9% |
| 当期(四半期)利益率 | 20.4% | 9.6% | 13.3% | 15.5% | 15.1% | 13.1% | △7.3pts | △2.4pts |
| 研究開発費 | 33 | 39 | 38 | 46 | 156 | 39 | +15.0% | △15.9% |
| 設備投資額 | 112 | 30 | 25 | 36 | 203 | 23 | △79.5% | △36.5% |
| 減価償却費 | 29 | 30 | 33 | 34 | 126 | 34 | +17.3% | +1.8% |
| 1株当たり配当金(円) | - | 18 | - | 19 | 37 | - | - | - |

2026年3月期第1四半期実績 増減要因

前期1Qに集中した中国地場向け装置の出荷が平常化し、売上収益は前年同期比21%減。
主に販売減少による売上総利益の減少により、調整後営業利益は前年同期比44%減。

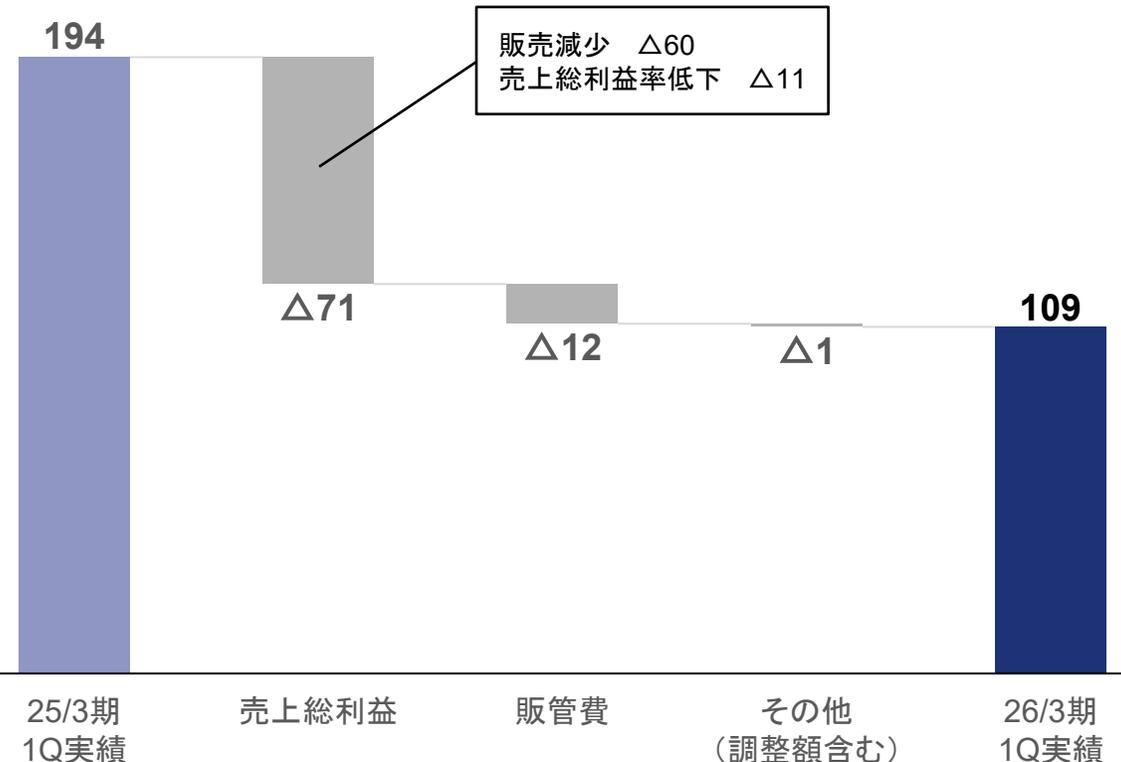
売上収益

(億円)



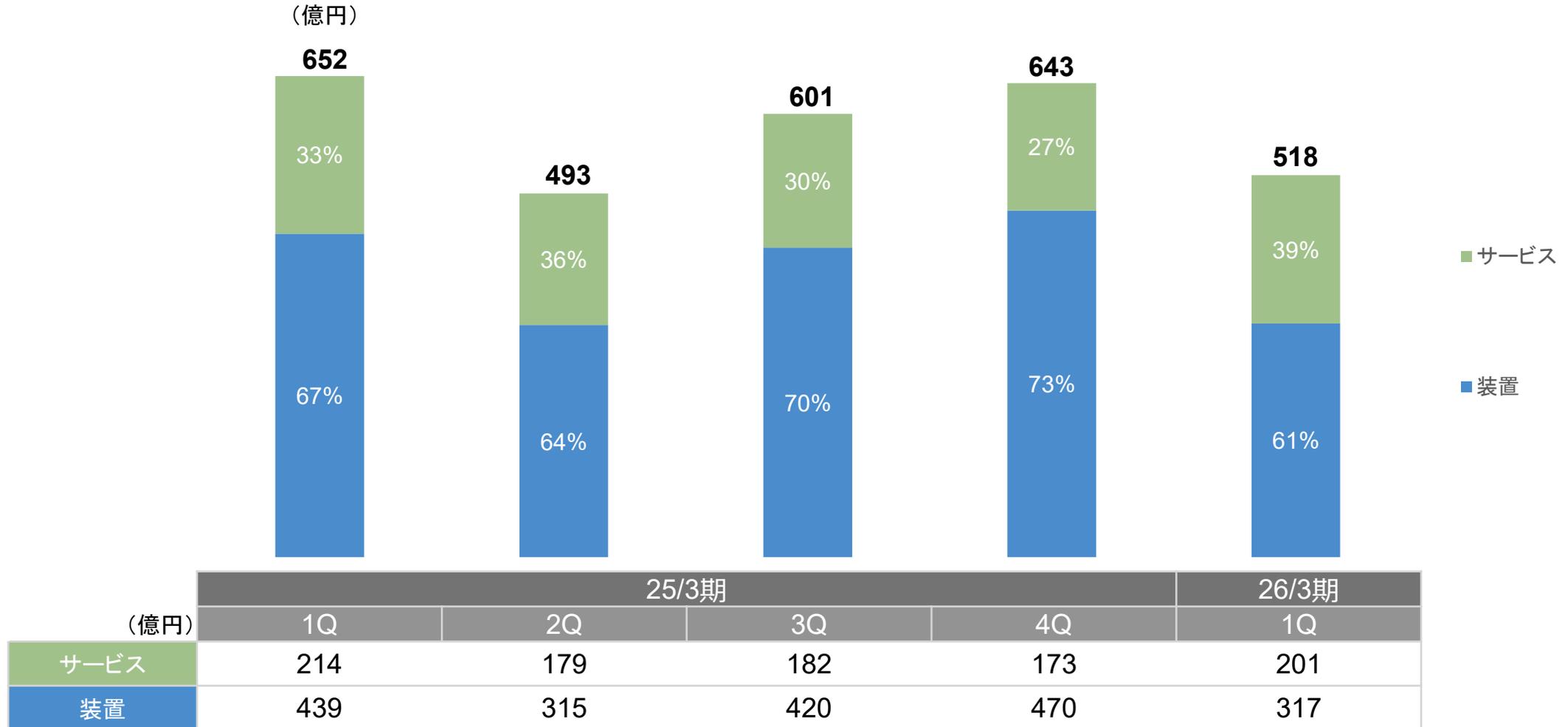
調整後営業利益

(億円)



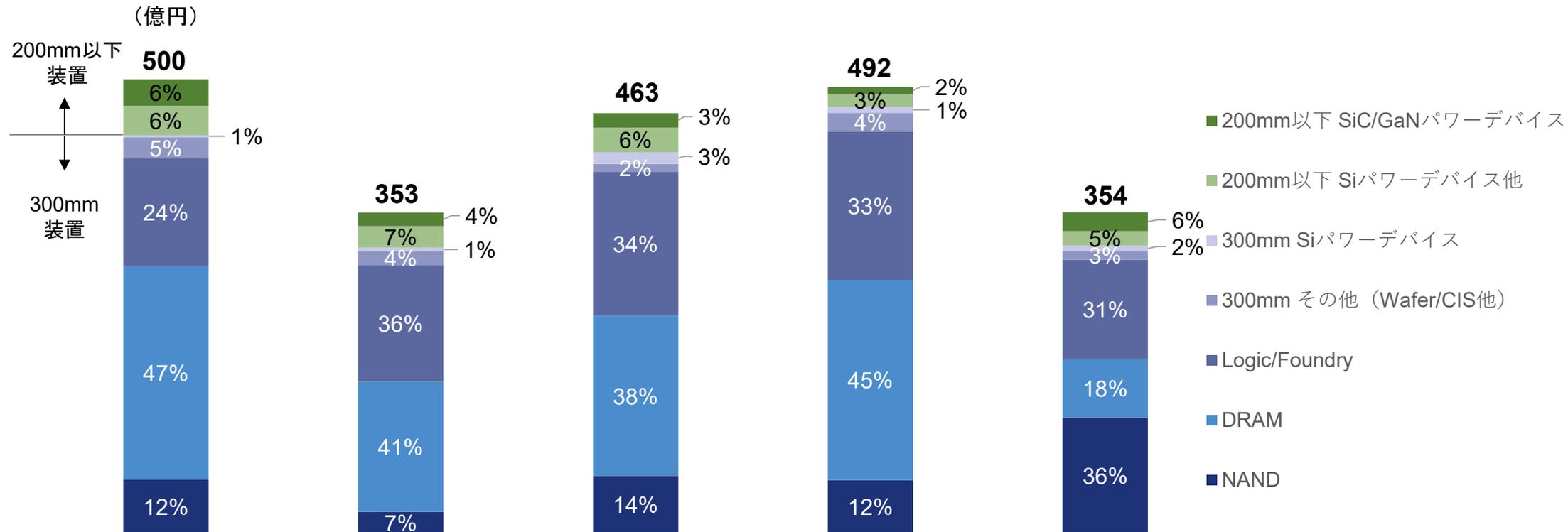
四半期別売上収益 ビジネス別

1Qは、前年同期比で装置売上28%減、サービス売上6%減。直前四半期比では装置売上が減少、サービス売上は増加。売上構成比は、サービス売上比率が増加。



四半期別売上収益 アプリケーション別 (300mm装置 + 200mm以下装置)

1Qは、前年同期比でNAND向け116%増、DRAM向け73%減、Logic/Foundry向け8%減。
直前四半期比でもNAND向けが伸長、DRAM、Logic/Foundry向けは減少も先端デバイス向けは好調維持。

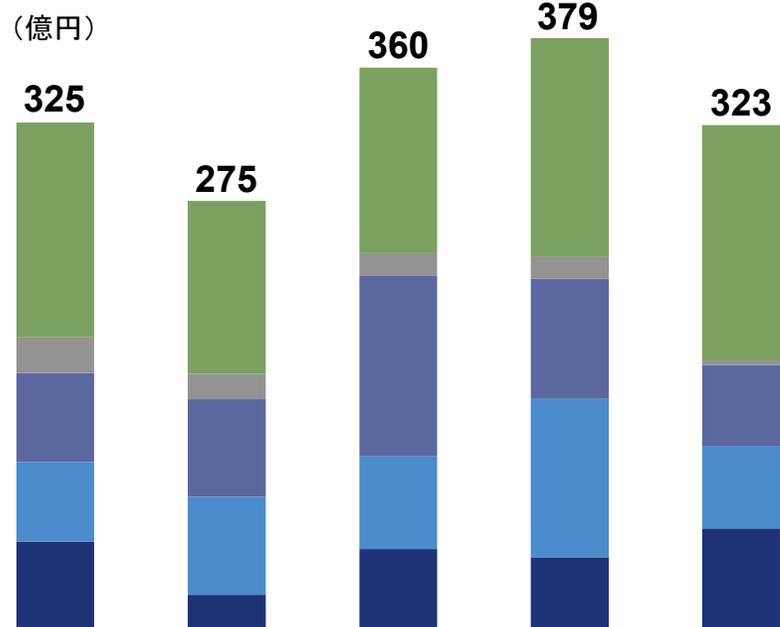


| (億円) | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 200mm以下装置 | 62 | 39 | 43 | 22 | 37 |
| 300mm装置 | 439 | 315 | 420 | 470 | 317 |

四半期別売上収益 アカウント別*1

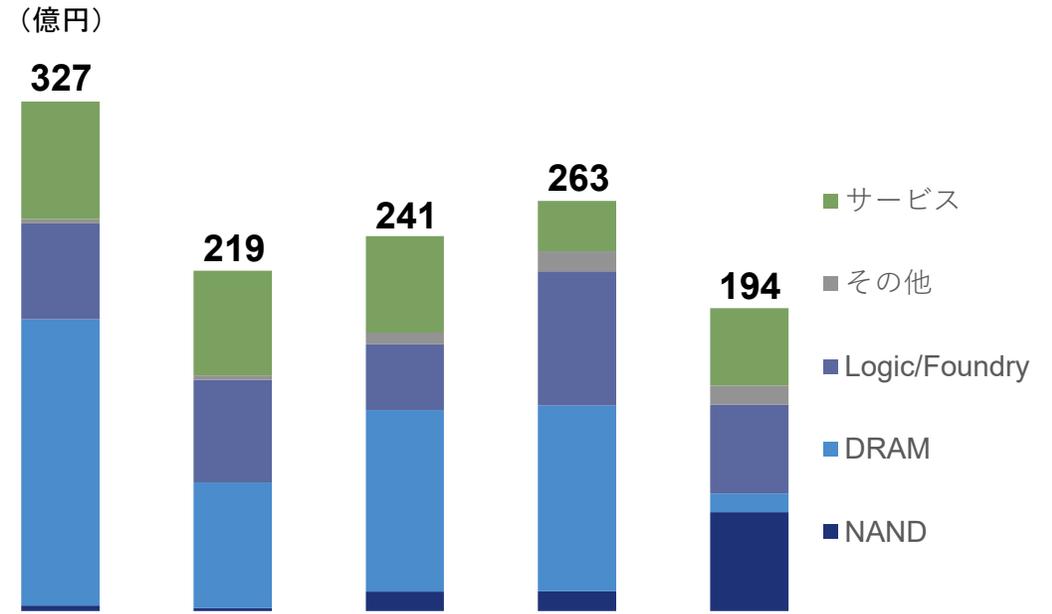
直前四半期との比較で、世界各国向け売上は、NAND向けが世代交代投資で伸長、DRAM、Logic/Foundry向けは下期偏重のため減少。中国地場向け売上は、NAND向けが投資回復で大幅増加、DRAM向けは投資端境期で大幅減少、Logic/Foundry向けは新興メーカーの投資軟調で減少。中国地場向け売上比率は38%に低下。

世界各国向け売上収益



| 世界各国比率 | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|--------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 世界各国比率 | 50% | 56% | 60% | 59% | 62% |

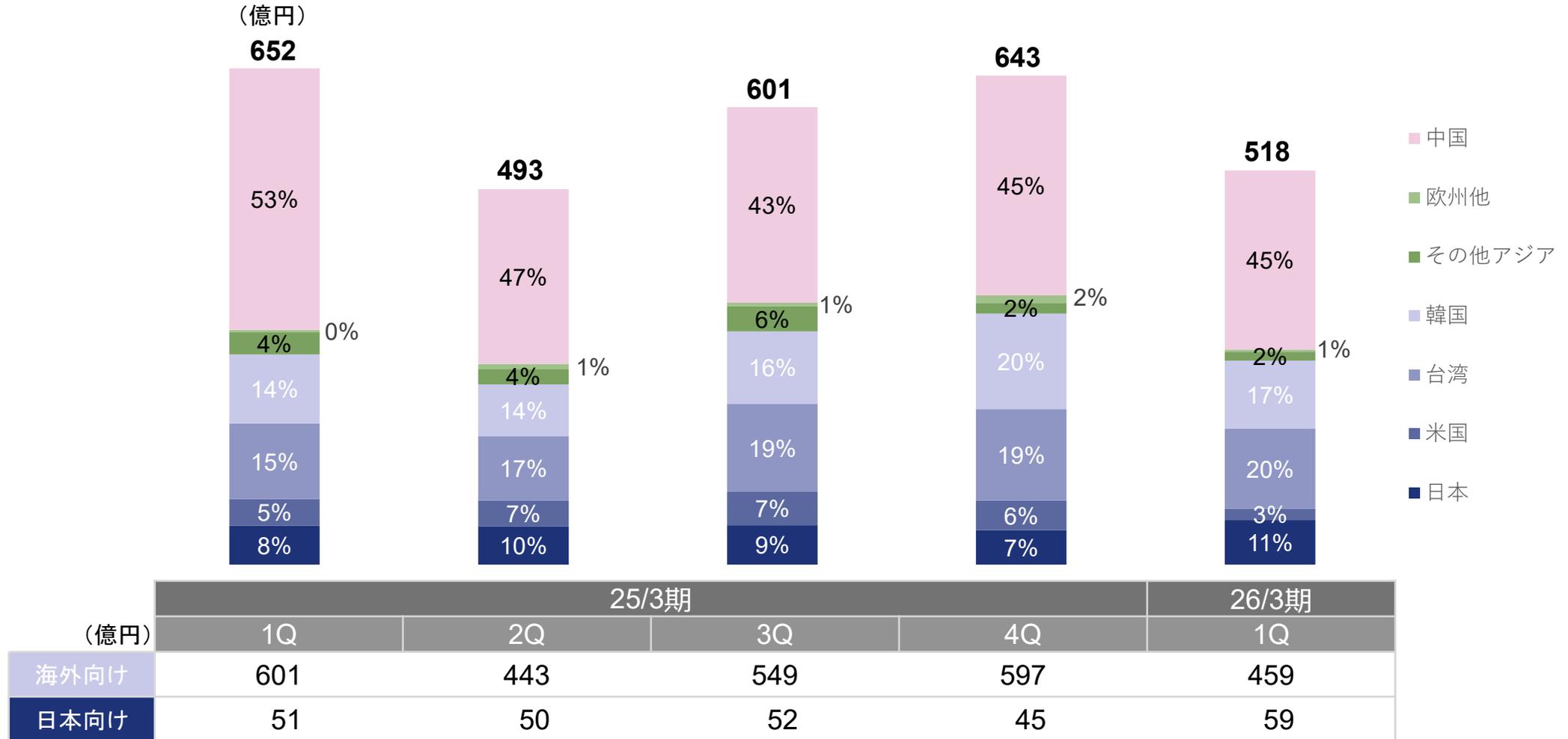
中国地場向け売上収益



| 中国地場比率 | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|--------|-------|-----|-----|-----|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 中国地場比率 | 50% | 44% | 40% | 41% | 38% |

四半期別売上収益 仕向地別

前年同期比で日本向け、台湾向けが増加。直前四半期比では日本向けが増加。
 米国仕向け売上は前年同期比、直前四半期比とも減少し、売上比率は3%に低下。

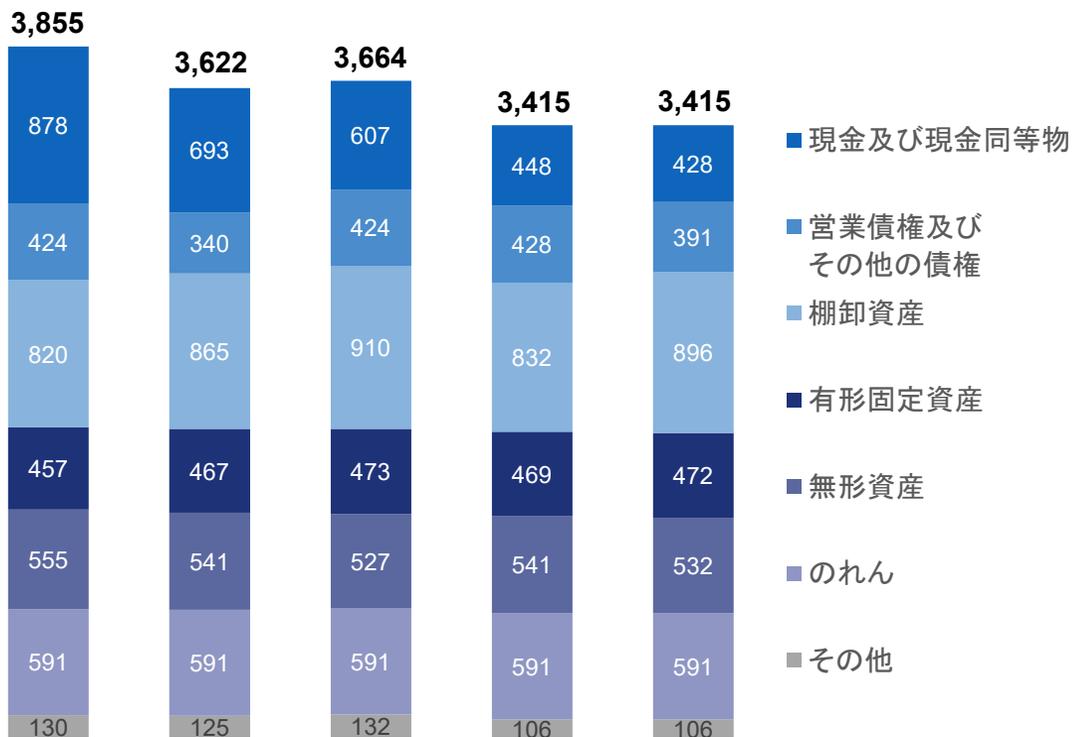


四半期別貸借対照表

資産合計は、現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権が減少したものの、生産の増加等に伴い棚卸資産が増加し、前期末と同額。資本合計は主に利益剰余金の増加により、前期末比で27億円増加。

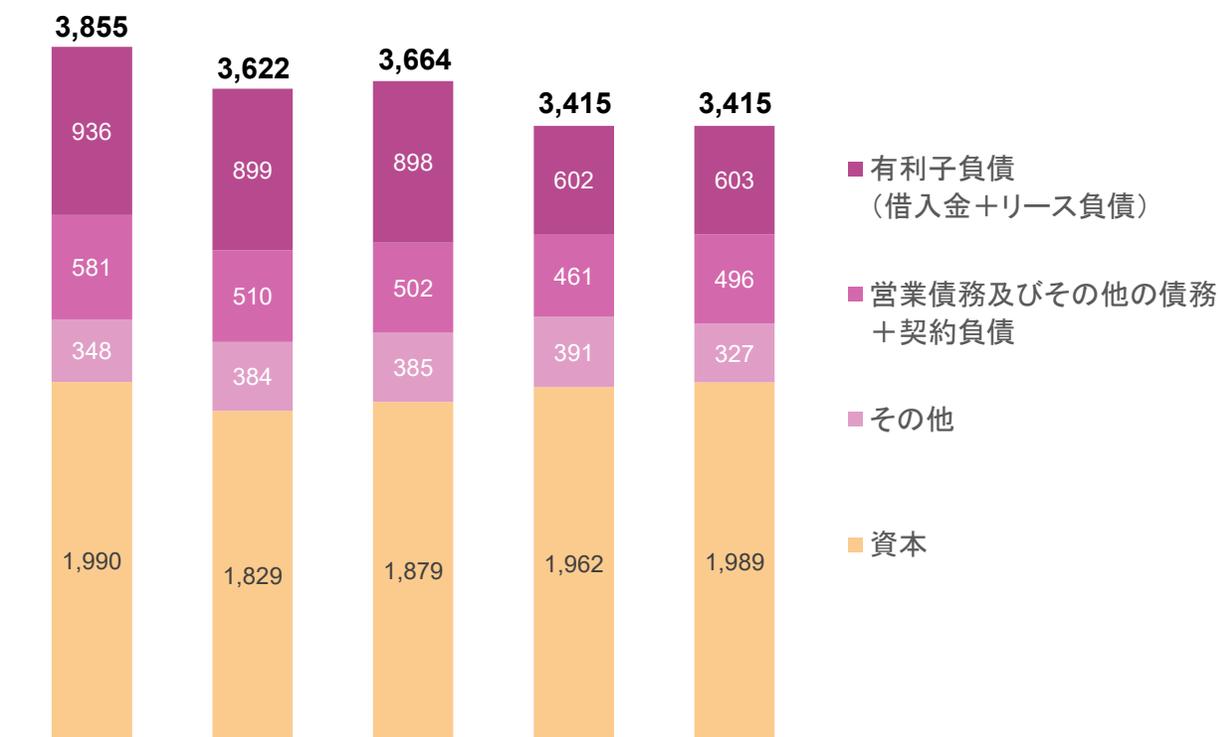
資産

(億円)



負債／資本

(億円)



25/3期

26/3期

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

25/3期

26/3期

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

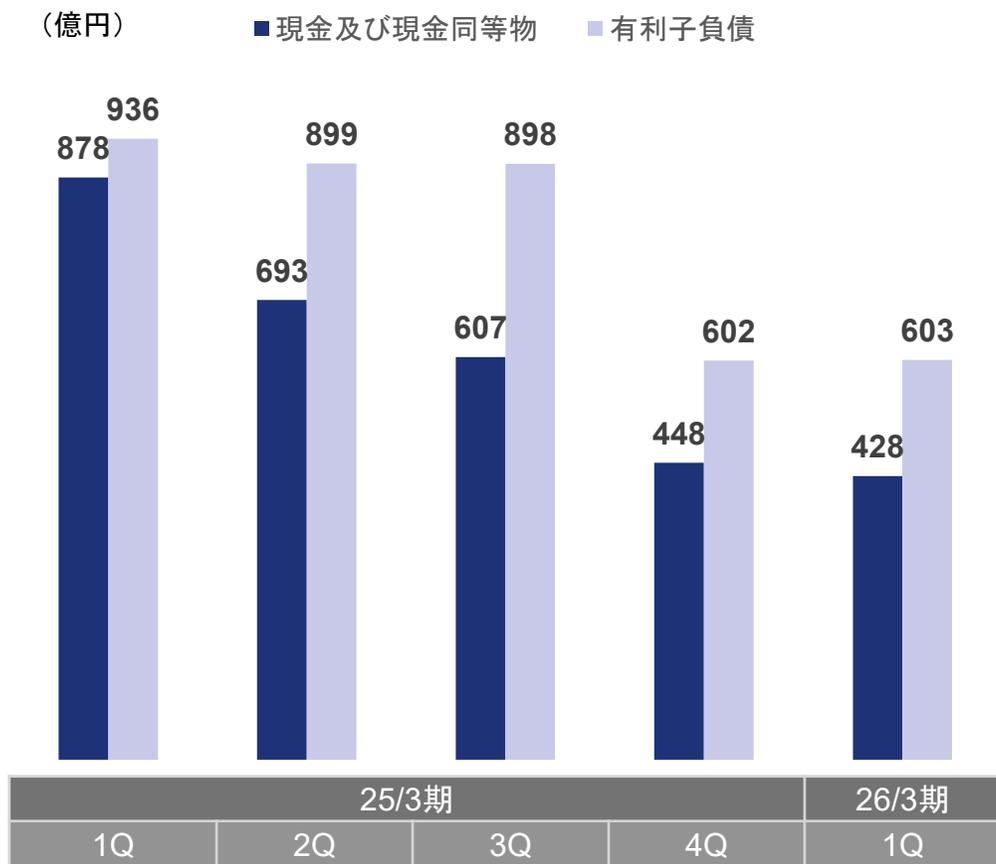
四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

自己資本比率は、前期末比で0.8ポイント増加し、58.2%。1Q末のネットデットは概ね計画通り175億円。

資産合計／資本合計／自己資本比率

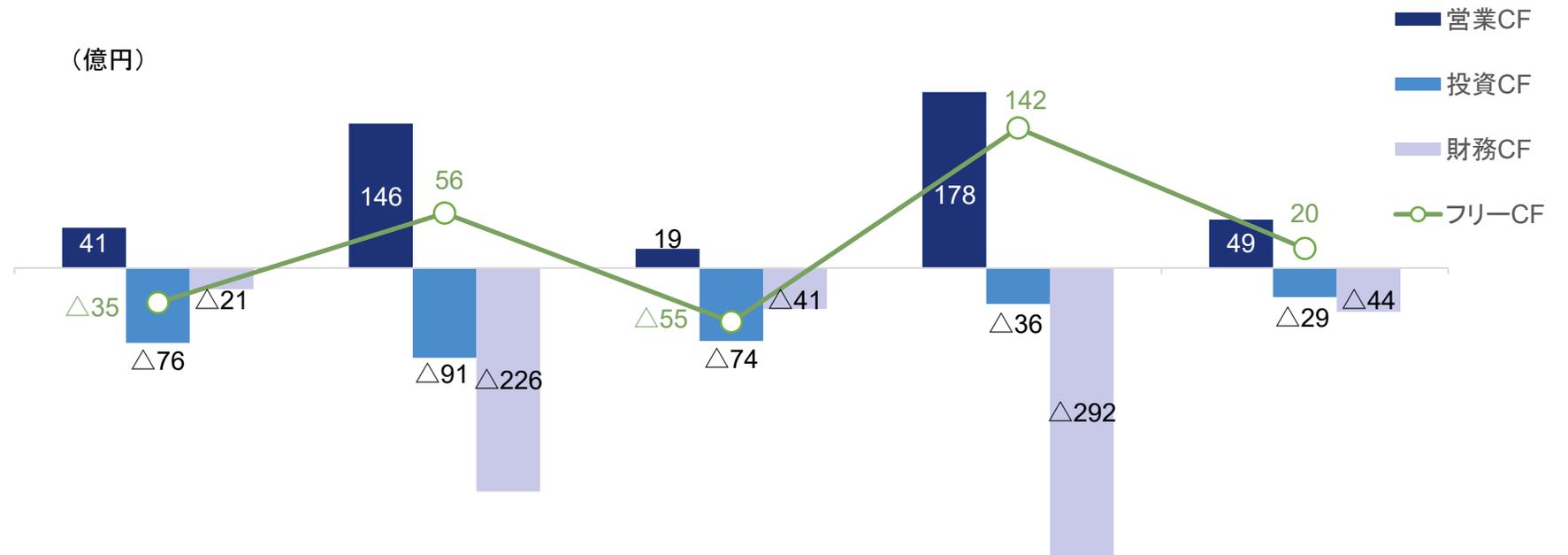


現金及び現金同等物／有利子負債



四半期別キャッシュ・フロー

1Qは、営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは20億円の収入。
 財務CFは、配当金の支払いによる支出等により44億円の支出。

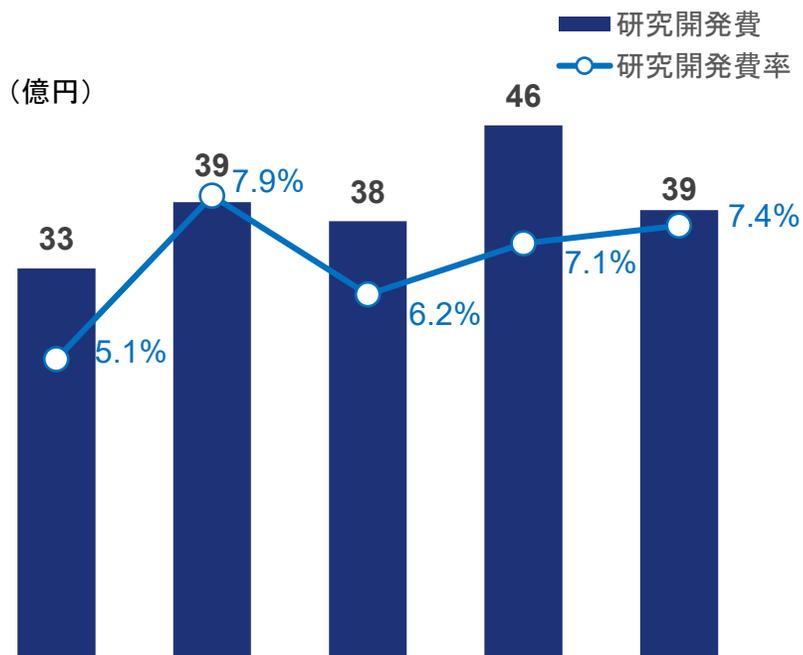


| (億円) | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|-------------|-------|------|-----|------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 営業CF | +41 | +146 | +19 | +178 | +49 |
| 投資CF | △76 | △91 | △74 | △36 | △29 |
| 財務CF | △21 | △226 | △41 | △292 | △44 |
| フリーCF | △35 | +56 | △55 | +142 | +20 |
| 現金及び現金同等物残高 | 878 | 693 | 607 | 448 | 428 |

四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

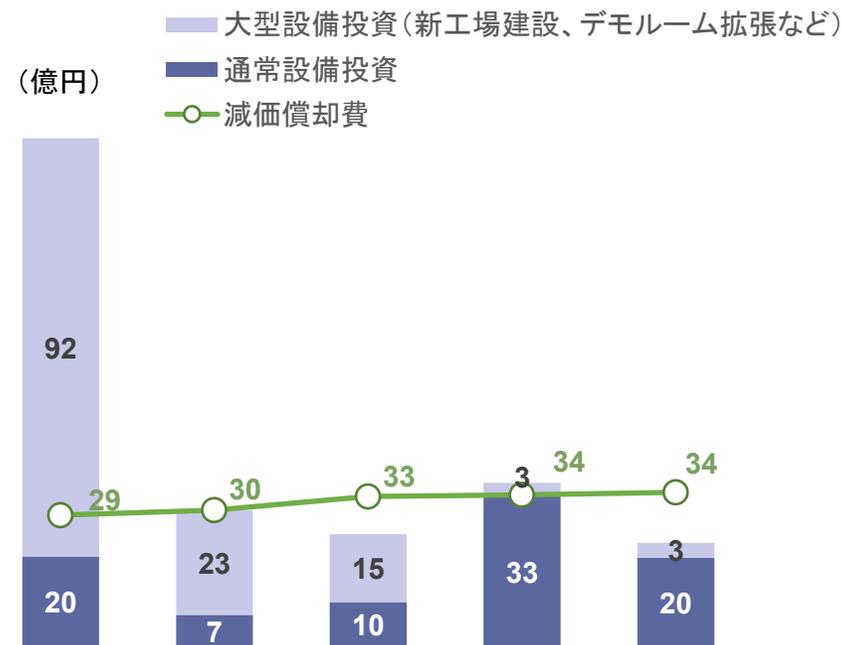
1Qの研究開発費は計画通り推移。売上収益減少に伴い、研究開発費率は7.4%に上昇。

研究開発費



| (億円) | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|-------|-------|------|------|------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 研究開発費 | 33 | 39 | 38 | 46 | 39 |
| 売上収益比 | 5.1% | 7.9% | 6.2% | 7.1% | 7.4% |

設備投資額／減価償却費



| (億円) | 25/3期 | | | | 26/3期 |
|--------|-------|------|------|------|-------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q |
| 設備投資額計 | 112 | 30 | 25 | 36 | 23 |
| 売上収益比 | 17.2% | 6.1% | 4.1% | 5.6% | 4.4% |
| 減価償却費 | 29 | 30 | 33 | 34 | 34 |
| 売上収益比 | 4.5% | 6.1% | 5.5% | 5.2% | 6.6% |



2026年3月期連結業績予想

2026年3月第1四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に設備投資が高水準で推移。NAND向け設備投資は再開。民生電子機器向けの需要回復は遅れ、自動車・産業機器向けの需要は軟調。
- 当社1Qは、前年同期に集中した中国地場向けの装置販売が平常化し、前年同期比で減収減益。先端デバイス向け装置販売・改造は好調。

2026年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 一部の半導体デバイスメーカーが設備投資の端境期を迎えているものの、先端デバイスの世代交代に向けた設備投資は今後も続く見通し。
- 上期は概ね計画通りに推移する見通し。下期には装置販売を中心に売上が伸長する見通しで、通期業績予想に変更なし。

2026年3月期業績・配当予想(5月13日公表)

25/3期比で2%増収、調整後営業利益、調整後当期利益は先行投資の影響で微減の計画に変更なし。期初計画に織り込み済みの関税政策による間接影響も含めて2Q決算発表時に下期予想を見直し。

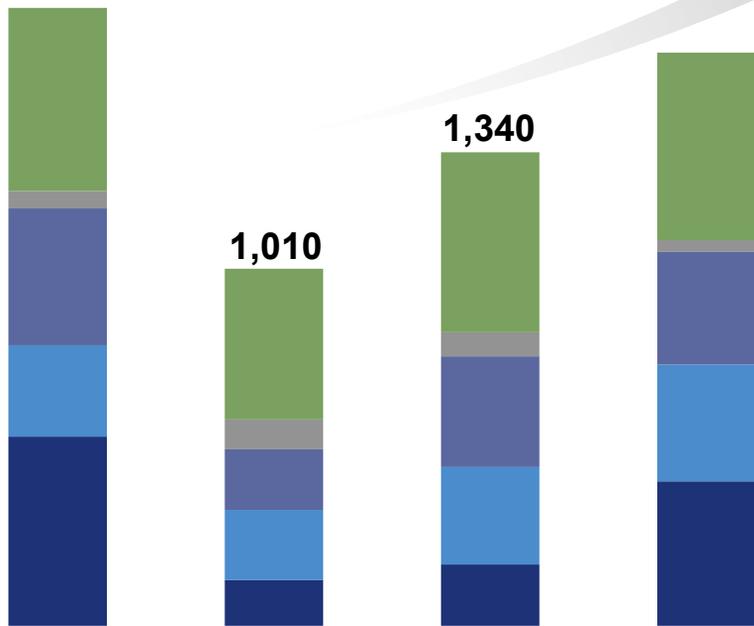
| (億円) | 25/3期 | | | 26/3期 | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 上期実績 | 下期実績 | 通期実績 | 上期予想 | 下期予想 | 通期予想 | 前期比 |
| 売上収益 | 1,145 | 1,244 | 2,389 | 1,040 | 1,400 | 2,440 | +2.1% |
| 売上総利益 | 514 | 504 | 1,017 | 441 | 603 | 1,044 | +2.7% |
| 売上総利益率 | 44.8% | 40.5% | 42.6% | 42.3% | 43.2% | 42.8% | +0.2pts |
| 調整後営業利益 | 307 | 271 | 578 | 200 | 353 | 552 | △4.4% |
| 調整後営業利益率 | 26.8% | 21.8% | 24.2% | 19.2% | 25.1% | 22.6% | △1.6pts |
| 調整後当期(半期)利益 | 216 | 207 | 423 | 140 | 260 | 401 | △5.2% |
| 調整後当期(半期)利益率 | 18.9% | 16.6% | 17.7% | 13.5% | 18.6% | 16.4% | △1.3pts |
| 営業利益 | 274 | 239 | 513 | 170 | 322 | 492 | △4.1% |
| 営業利益率 | 24.0% | 19.2% | 21.5% | 16.3% | 23.0% | 20.2% | △1.3pts |
| 税引前当期(半期)利益 | 279 | 228 | 508 | 165 | 319 | 484 | △4.7% |
| 税引前当期(半期)利益率 | 24.4% | 18.4% | 21.3% | 15.9% | 22.8% | 19.8% | △1.5pts |
| 当期(半期)利益 | 181 | 180 | 360 | 119 | 240 | 360 | △0.0% |
| 当期(半期)利益率 | 15.8% | 14.4% | 15.1% | 11.4% | 17.2% | 14.7% | △0.3pts |
| 1株当たり配当金(円) | 18 | 19 | 37 | 18 | 18 | 36 | △1円 |
| 配当性向(調整後当期利益ベース) | — | — | 20.4% | — | — | 20.9% | +0.5% |

2026年3月期業績予想 アカウント別*1売上収益(5月13日公表)

世界各国向け売上は、3D NAND向け、先端DRAM、Logic GAA向けの伸長を見込む。
 中国地場向け売上は、DRAM向けが投資の端境期にあたるものの、NAND向けは3期ぶりの売上回復を見込む。

世界各国向け売上収益

(億円)
1,748

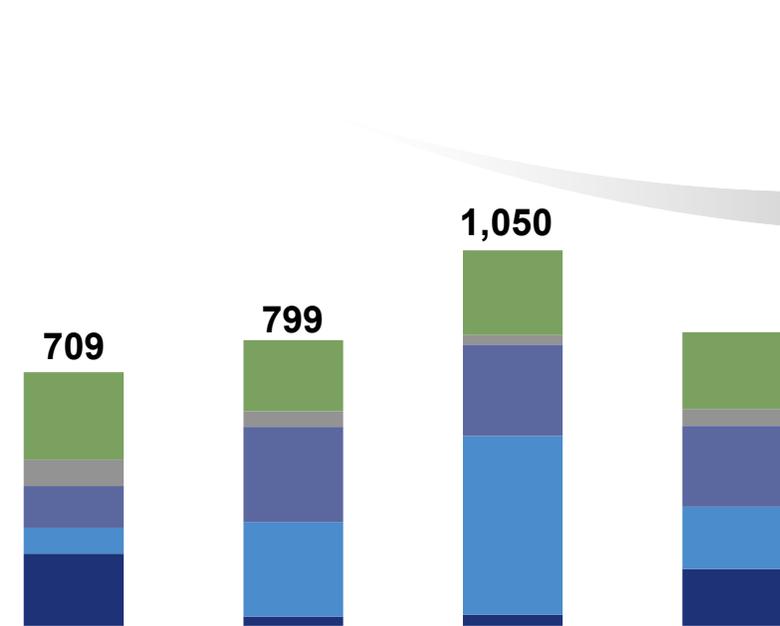


世界各国比率

| 期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 予想 |
|--------|-------|-------|-------|----------|
| 比率 (%) | 71% | 56% | 56% | 67% |

中国地場向け売上収益

(億円)



中国地場比率

| 期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 予想 |
|--------|-------|-------|-------|----------|
| 比率 (%) | 29% | 44% | 44% | 33% |

- サービス
- その他
- Logic/Foundry
- DRAM
- NAND



今後の見通し

事業環境の見通し

CY25のWFEはCY24並みの予想に変更なし。先端デバイスの好調、成熟ノードLogic/Foundryの停滞や汎用メモリの回復遅れの見方に変更なし。長期的に大きな成長を遂げるとの見方も変更なし。

半導体デバイス市場

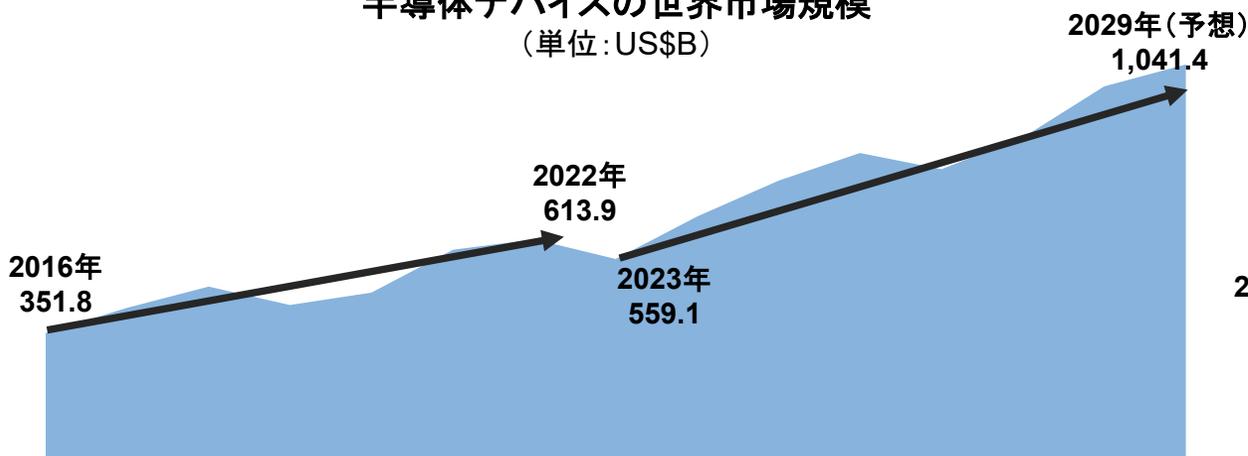
- 半導体デバイス市場では、生成AI関連の需要が引き続き市場をけん引し、汎用DRAMは回復に遅れ。
- 成熟ノード向けの設備投資は落ち着き、中国では相応の規模が持続するものの、欧米では投資抑制が続く。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、グリーントランスフォーメーションへの投資等により、大きな成長が期待される。

半導体製造装置(WFE)市場

- 先端デバイス向け装置需要が増加基調を継続。成熟ノード向け装置需要は停滞。
- WFEのCY25規模はCY24と同水準、うち世界各国向けは前年比10~20%増、中国地場向けは前年比20~30%減を見込む。
- 中長期的には大きな成長が期待され、今後数年で1,200億ドル程度まで成長するとの想定には変更なし。

半導体デバイスの世界市場規模

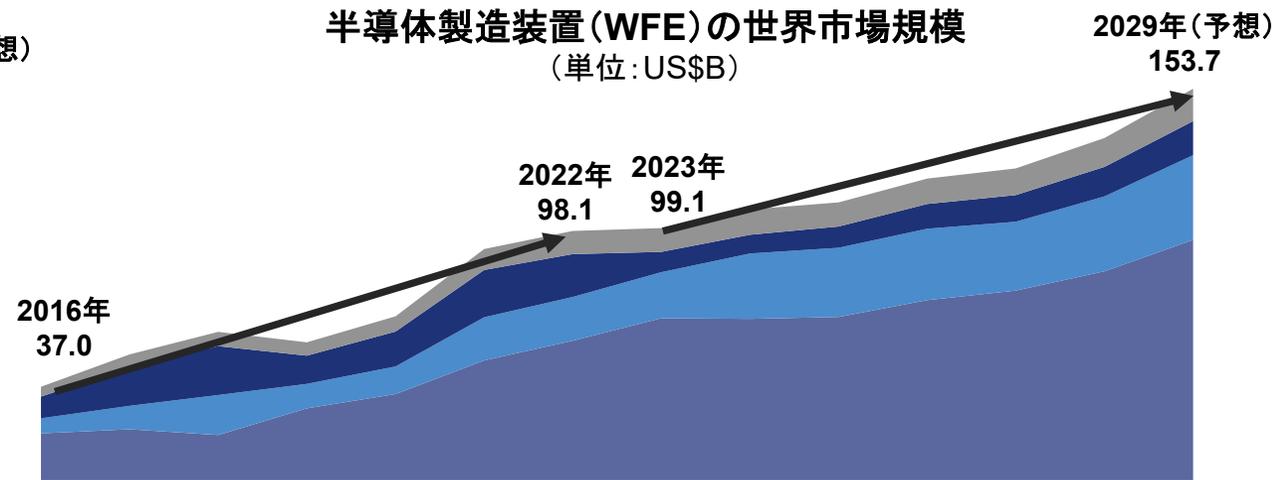
(単位:US\$B)



出所: Techinsights Inc. 2025-06-14 - Semiconductor Forecast Q2 2025 Update
Techinsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (Jun-2025)

半導体製造装置(WFE)の世界市場規模

(単位:US\$B)



Logic/Foundry DRAM NAND Others

アプリケーション別の事業環境と当社の状況

先端DRAM、Logic/Foundryが世界各国向け装置需要を引き続きけん引。
NANDでは、世界各国向け、中国地場向けとも世代交代に伴う高付加価値装置の需要が続く見通し。

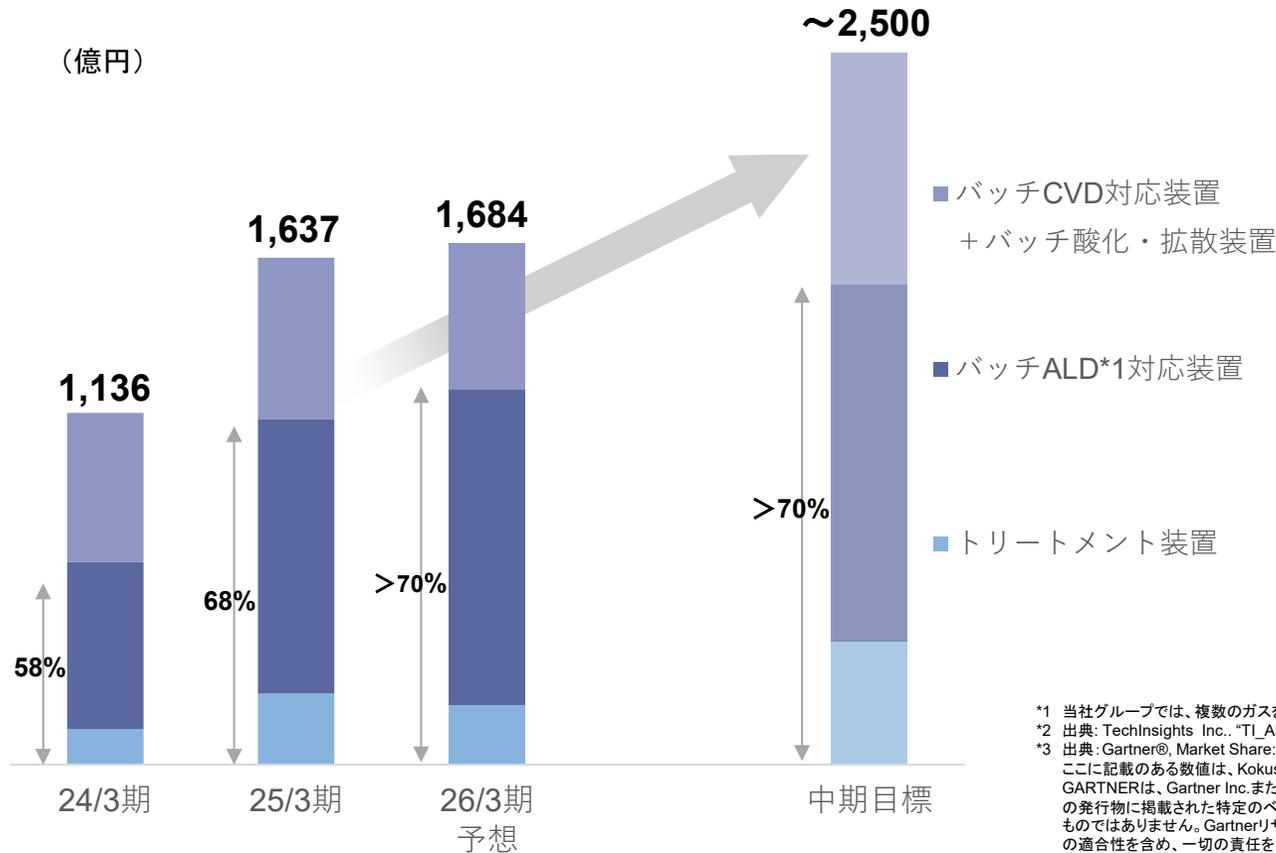
下線は、通期決算発表時点からの主な変更箇所です。

| | 事業環境 | 当社 |
|------------------------------|--|--|
| NAND | <ul style="list-style-type: none"> 世界各国向けでデバイス世代交代に向けた装置需要が回復。 中国地場向けでも3期ぶりに需要回復。 | <ul style="list-style-type: none"> デバイス世代交代に伴い高付加価値製品の販売・改造が増加。 中国地場向けは上期中心に売上回復、世界各国向けは売上回復基調継続、第4四半期に売上規模拡大の見通し。 |
| DRAM | <ul style="list-style-type: none"> HBMの進化に伴って先端デバイスの世代交代、生産規模拡大に向けた装置需要が増加。 中国大手デバイスメーカーの投資端境期にあたる25年前半は一時的に需要が減少。 | <ul style="list-style-type: none"> D1c世代に対するテクノロジー投資で装置・改造売上が増加。バッチALD*1対応装置、枚葉トリートメント装置の獲得済み新規PORが収益に寄与、次世代でもPOR拡大をめざす。 関税の間接影響を考慮し、汎用DRAM向けは慎重に見積もり。 |
| Logic/Foundry | <ul style="list-style-type: none"> 最大手デバイスメーカーの積極投資により、先端デバイス向け装置需要が増加。 中国成熟ノード向け装置需要は相応の規模が持続、欧米成熟ノード向け装置需要は一定期間、投資抑制が続く。 | <ul style="list-style-type: none"> GAA第1世代向けは順調に売上が増加、今後のGAA第2世代以降の世代交代に伴う売上拡大に期待。 欧米成熟ノード向けはシェア拡大に向けた取り組みを継続し、需要回復に備える。 |
| SiC/GaNパワーデバイス (サービスビジネス) | <ul style="list-style-type: none"> 世界各国では需要減少も、中国では需要持続。 ウェーハサイズが150mmから200mmに移行するのに合わせて需要拡大に期待。 | <ul style="list-style-type: none"> 既存製品の売上伸長、高温活性化アニール新製品で初POR獲得。 ALD*1関連の新たなソリューション開発にも注力。 |

製品構成の現状と見通し(5月13日公表)

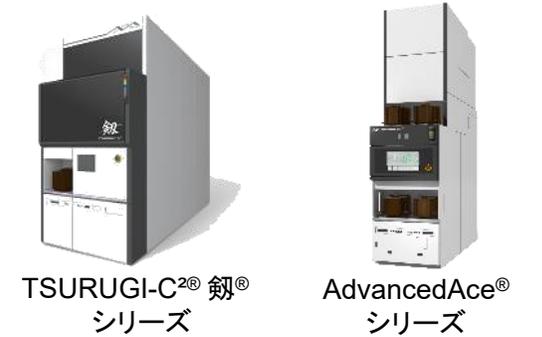
デバイスの世代交代に伴い、バッチALD*1対応装置、枚葉トリートメント装置の構成比が拡大。中国地場向け売上比率の低下による影響を吸収し、収益性が上昇する見通し。

装置売上(サービス売上含まず)



バッチ処理装置

- バッチALD対応装置
世界シェア No.1 (2024年)*2
- バッチCVD対応装置
- バッチ酸化・拡散装置



トリートメント装置

- Plasma Gate Modification Tools
世界シェア No.1 (2024年)*3
- Others



*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

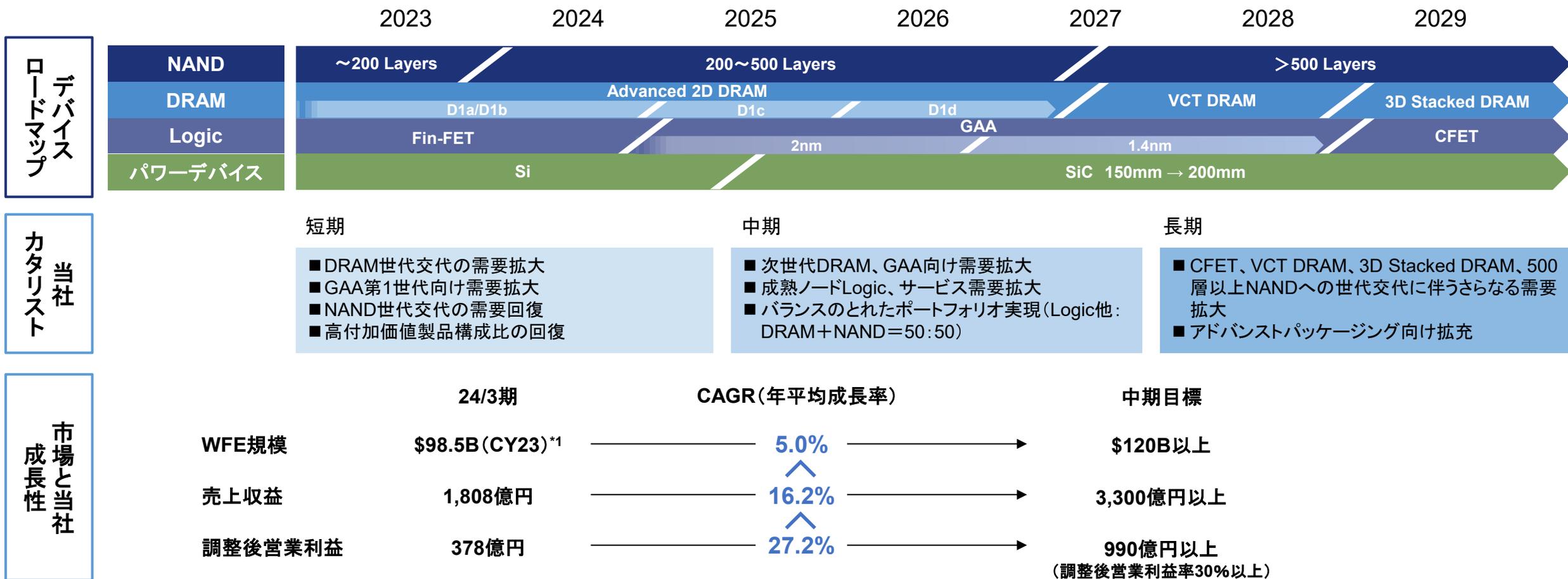
*2 出典: TechInsights Inc. "TI_ALD Tools_YEARLY" (April 2025)

*3 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al, Published 21 April 2025

ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。トリートメント装置: RTP and Oxidation/Diffusion。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容は、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

まとめ(5月13日公表)

半導体デバイスの進化に伴う微細化・複雑化・三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大をめざす。

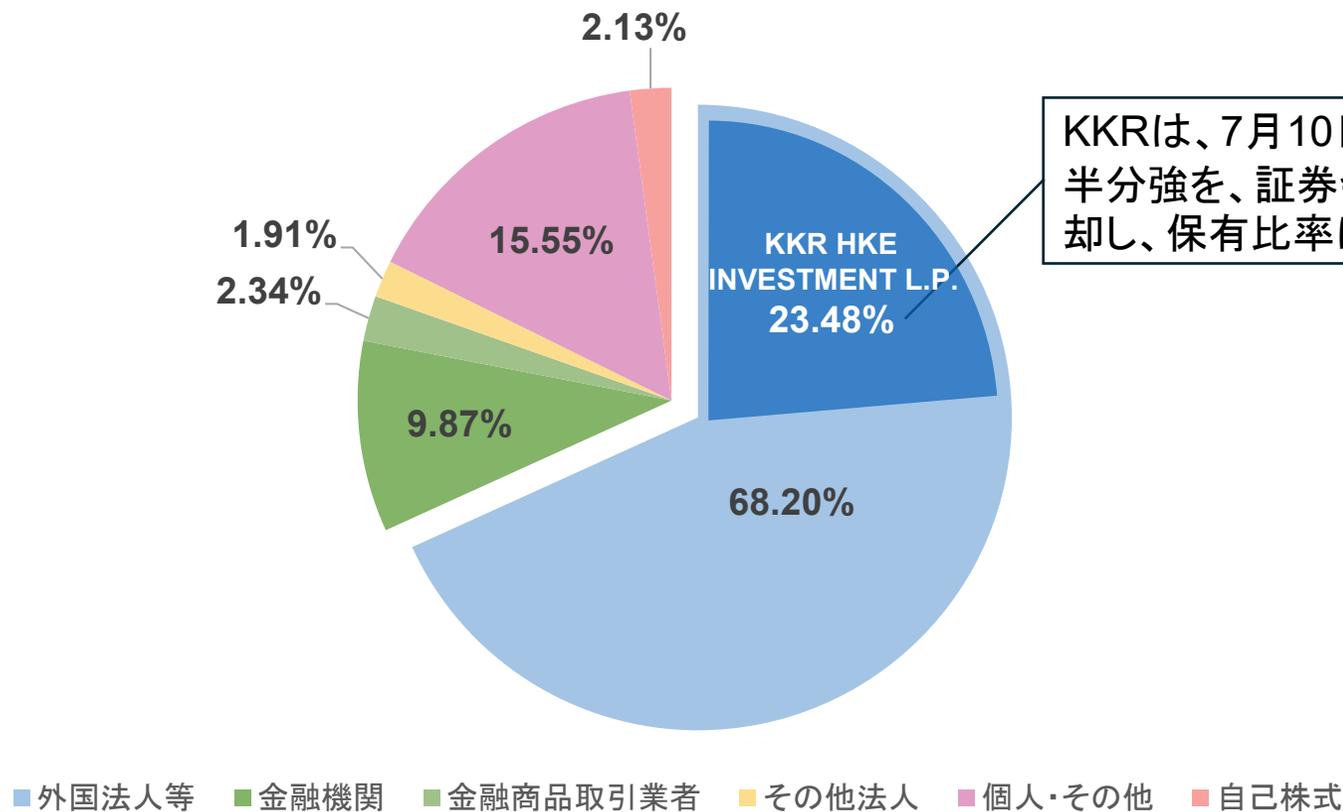


*1 出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

KKRの当社保有株式一部売却について

KKRが当社株式の一部を機関投資家に売却し、KKRの保有比率は11%に低下。

株主構成(25年3月31日現在)





Appendix

2026年3月期第1四半期の主な活動報告

経営・事業活動

- 横浜国立大学との共同研究により次世代3D半導体デバイスの省エネルギー化に貢献する新規膜とその接合プロセスを実証。(25/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査「Global Semiconductor Supplier Awards」で「Top 10 Customer Service」を28年連続で受賞。(25/5)
- 「SEMICON® Southeast Asia 2025」に出展。(25/5)
- 「MEMS Engineer FORUM 2025」に出展。(25/4)



「FAB EQUIPMENT」「WFE TO SPECIALTY CHIP MAKERS」の
両部門において、トップ10にランクイン

ESGの取り組み

- 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定。(25/6)
- 保育所施設で青空環境教室を実施。(25/5)
- 100%再生可能エネルギーの使用をめざす国際イニシアティブ「RE100」に参画。(25/4)
- 富山事業所で「とやま水の郷でんき」の使用量を全体の35%に引き上げ。(25/4)
- 富山県砺波市で開催される「2025となみチューリップフェア」に協賛。(25/4)
- 富山マラソン2025にゴールドパートナーとしての協賛を決定。(25/4)



富山マラソン2025に
ゴールドパートナーとして協賛

損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

| (百万円) | 25/3期 | | | | | 26/3期 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q |
| 売上収益 | 65,224 | 49,324 | 60,117 | 64,268 | 238,933 | 51,789 |
| 売上総利益 | 29,354 | 22,012 | 24,865 | 25,512 | 101,743 | 22,220 |
| 売上総利益率 | 45.0% | 44.6% | 41.4% | 39.7% | 42.6% | 42.9% |
| 調整後営業利益 | 19,382 | 11,299 | 13,876 | 13,196 | 57,753 | 10,902 |
| 調整後営業利益率 | 29.7% | 22.9% | 23.1% | 20.5% | 24.2% | 21.1% |
| 調整後当期(四半期)利益 | 14,345 | 7,262 | 9,646 | 11,050 | 42,303 | 7,598 |
| 調整後当期(四半期)利益率 | 22.0% | 14.7% | 16.0% | 17.2% | 17.7% | 14.7% |
| 営業利益 | 17,878 | 9,562 | 12,274 | 11,606 | 51,320 | 9,717 |
| 営業利益率 | 27.4% | 19.4% | 20.4% | 18.1% | 21.5% | 18.8% |
| 税引前当期(四半期)利益 | 17,747 | 10,195 | 11,241 | 11,606 | 50,789 | 9,322 |
| 税引前当期(四半期)利益率 | 27.2% | 20.7% | 18.7% | 18.1% | 21.3% | 18.0% |
| 当期(四半期)利益 | 13,302 | 4,751 | 8,004 | 9,947 | 36,004 | 6,776 |
| 当期(四半期)利益率 | 20.4% | 9.6% | 13.3% | 15.5% | 15.1% | 13.1% |
| 研究開発費 | 3,348 | 3,920 | 3,755 | 4,581 | 15,604 | 3,851 |
| 設備投資額 | 11,215 | 3,015 | 2,494 | 3,624 | 20,348 | 2,302 |
| 減価償却費 | 2,914 | 3,027 | 3,328 | 3,357 | 12,625 | 3,417 |

調整後利益等の計算における調整項目

| | (百万円) | 25/3期 | | | | | 26/3期 |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q |
| 営業利益 | | 17,878 | 9,562 | 12,274 | 11,606 | 51,320 | 9,717 |
| －その他の収益 | | △92 | △187 | △28 | △41 | △348 | △304 |
| ＋その他の費用 | | 27 | 78 | 79 | 69 | 253 | 18 |
| (調整額) | | | | | | | |
| ＋企業結合により識別した無形資産等の償却 | | 1,479 | 1,477 | 1,475 | 1,476 | 5,907 | 1,476 |
| ＋スタンドアローン関連費用 | | 12 | 298 | 3 | 4 | 317 | - |
| ＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く) | | 78 | 71 | 73 | 82 | 304 | △5 |
| 調整額 計 | | 1,569 | 1,846 | 1,551 | 1,562 | 6,528 | 1,471 |
| 調整後営業利益 | | 19,382 | 11,299 | 13,876 | 13,196 | 57,753 | 10,902 |
| 当期(四半期)利益 | | 13,302 | 4,751 | 8,004 | 9,947 | 36,004 | 6,776 |
| －その他の収益 | | △92 | △187 | △28 | △41 | △348 | △304 |
| ＋その他の費用 | | 27 | 78 | 79 | 69 | 253 | 18 |
| (調整額) | | | | | | | |
| ＋企業結合により識別した無形資産等の償却 | | 1,479 | 1,477 | 1,475 | 1,476 | 5,907 | 1,476 |
| ＋スタンドアローン関連費用 | | 12 | 298 | 3 | 4 | 317 | - |
| ＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く) | | 78 | 71 | 73 | 82 | 304 | △5 |
| －調整項目に対する税金調整額 | | △461 | △531 | △491 | △487 | △1,970 | △363 |
| ＋一時的な税金費用の調整額 | | - | 1,305 | 531 | - | 1,836 | - |
| 調整後当期(四半期)利益 | | 14,345 | 7,262 | 9,646 | 11,050 | 42,303 | 7,598 |

貸借対照表及び主要財務指標

| | | 25/3期 | | | | | 26/3期 | | | 25/3期 | | | | | 26/3期 | | |
|------|------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | (百万円) | | | | | 1Q末 | | | (百万円) | | | | | 1Q末 | | |
| | | 1Q末 | 2Q末 | 3Q末 | 4Q末 | 1Q末 | | | 1Q末 | 2Q末 | 3Q末 | 4Q末 | 1Q末 | | | | |
| 資産 | 流動資産 | 現金及び現金同等物 | 87,775 | 69,333 | 60,722 | 44,755 | 42,766 | 負債 | 流動負債 | 借入金＋リース負債 | 8,055 | 8,843 | 8,843 | 11,928 | 11,956 | | |
| | | 営業債権及びその他の債権 | 42,444 | 33,979 | 42,369 | 42,835 | 39,087 | | | 営業債務及びその他の債務 | 38,657 | 31,275 | 30,328 | 23,606 | 24,574 | | |
| | | 棚卸資産 | 82,028 | 86,542 | 91,019 | 83,200 | 89,626 | | | 契約負債 | 19,394 | 19,734 | 19,822 | 22,455 | 25,069 | | |
| | | その他 | 2,787 | 1,923 | 1,923 | 2,062 | 2,038 | | | その他 | 19,554 | 22,510 | 23,180 | 24,682 | 17,991 | | |
| | | 流動資産合計 | 215,034 | 191,777 | 196,033 | 172,852 | 173,517 | | | 流動負債合計 | 85,660 | 82,362 | 82,173 | 82,671 | 79,590 | | |
| | | 非流動資産 | 有形固定資産 | 45,696 | 46,714 | 47,341 | 46,904 | | 47,220 | | 非流動負債 | 借入金＋リース負債 | 85,555 | 81,059 | 80,982 | 48,256 | 48,339 |
| | | | のれん | 59,065 | 59,065 | 59,065 | 59,065 | | 59,065 | | | その他 | 15,199 | 15,900 | 15,344 | 14,417 | 14,663 |
| | | | 無形資産 | 55,480 | 54,073 | 52,652 | 54,139 | | 53,182 | | | 非流動負債合計 | 100,754 | 96,959 | 96,326 | 62,673 | 63,002 |
| | | | その他 | 10,179 | 10,609 | 11,309 | 8,552 | | 8,524 | | 負債合計 | 186,414 | 179,321 | 178,499 | 145,344 | 142,592 | |
| | | | 非流動資産合計 | 170,420 | 170,461 | 170,367 | 168,660 | | 167,991 | | 資本合計 | 199,040 | 182,917 | 187,901 | 196,168 | 198,916 | |
| 資産合計 | | 385,454 | 362,238 | 366,400 | 341,512 | 341,508 | | 負債及び資本合計 | 385,454 | 362,238 | 366,400 | 341,512 | 341,508 | | | | |

| | 25/3期 | | | | | 26/3期 |
|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|
| | 1Q末 | 2Q末 | 3Q末 | 4Q末 | 1Q末 | |
| 自己資本比率 | 51.6% | 50.5% | 51.3% | 57.4% | 58.2% | |
| D/Eレシオ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| ネット・キャッシュ(百万円) | △ 5,835 | △ 20,569 | △ 29,103 | △ 15,429 | △ 17,529 | |

キャッシュ・フロー計算書

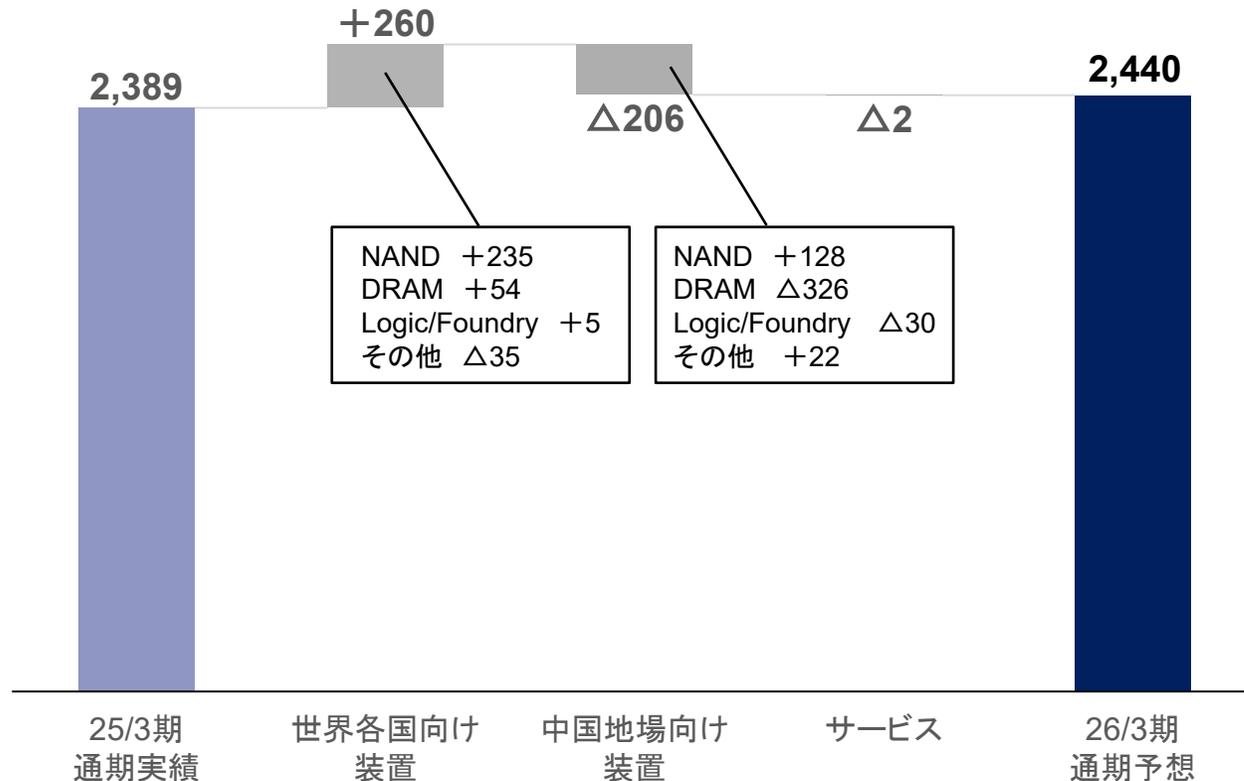
| | 25/3期 | | | | | 26/3期 |
|------------------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 通期 | 1Q |
| (百万円) | | | | | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,073 | 14,649 | 1,936 | 17,819 | 38,477 | 4,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,582 | △ 9,090 | △ 7,393 | △ 3,641 | △ 27,706 | △ 2,942 |
| フリー・キャッシュ・フロー | △ 3,509 | 5,559 | △ 5,457 | 14,178 | 10,771 | 1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,143 | △ 22,628 | △ 4,128 | △ 29,207 | △ 58,106 | △ 4,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,619 | 87,775 | 69,333 | 60,722 | 92,619 | 44,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,775 | 69,333 | 60,722 | 44,755 | 44,755 | 42,766 |

2026年3月期業績予想 増減要因(5月13日公表)

デバイスメーカーの生産規模拡大に向けた投資を慎重に見積もり、世代交代投資を中心に売上収益は前期比2%増を見込む。売上総利益率は上昇、調整後営業利益は先行投資による販管費増加により4%減を見込む。

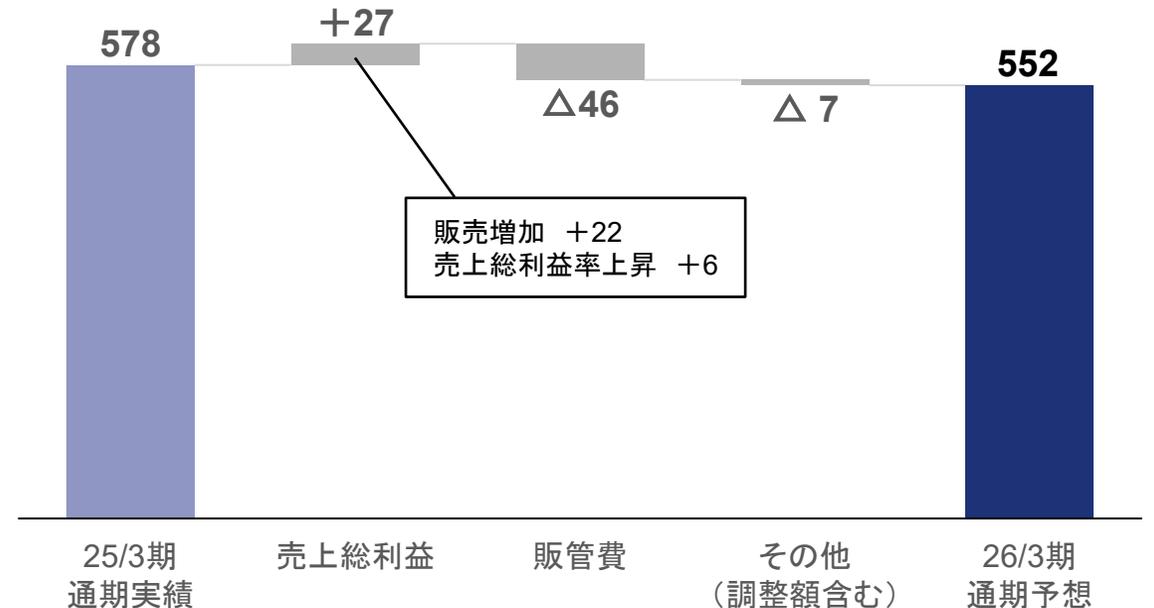
売上収益

(億円)



調整後営業利益

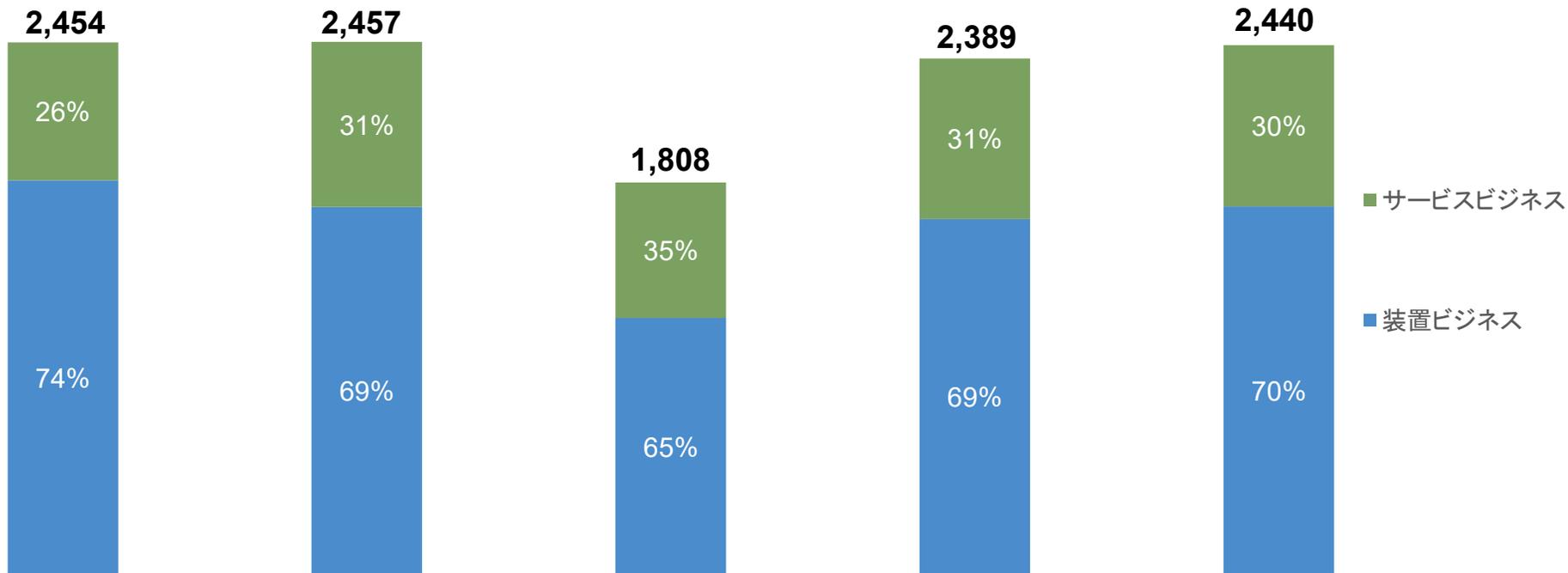
(億円)



2026年3月期業績予想 ビジネス別売上収益(5月13日公表)

装置売上は前期比3%増、サービス売上は前期並みを見込む。
 売上構成比は装置売上比率が70%まで回帰する見通し。

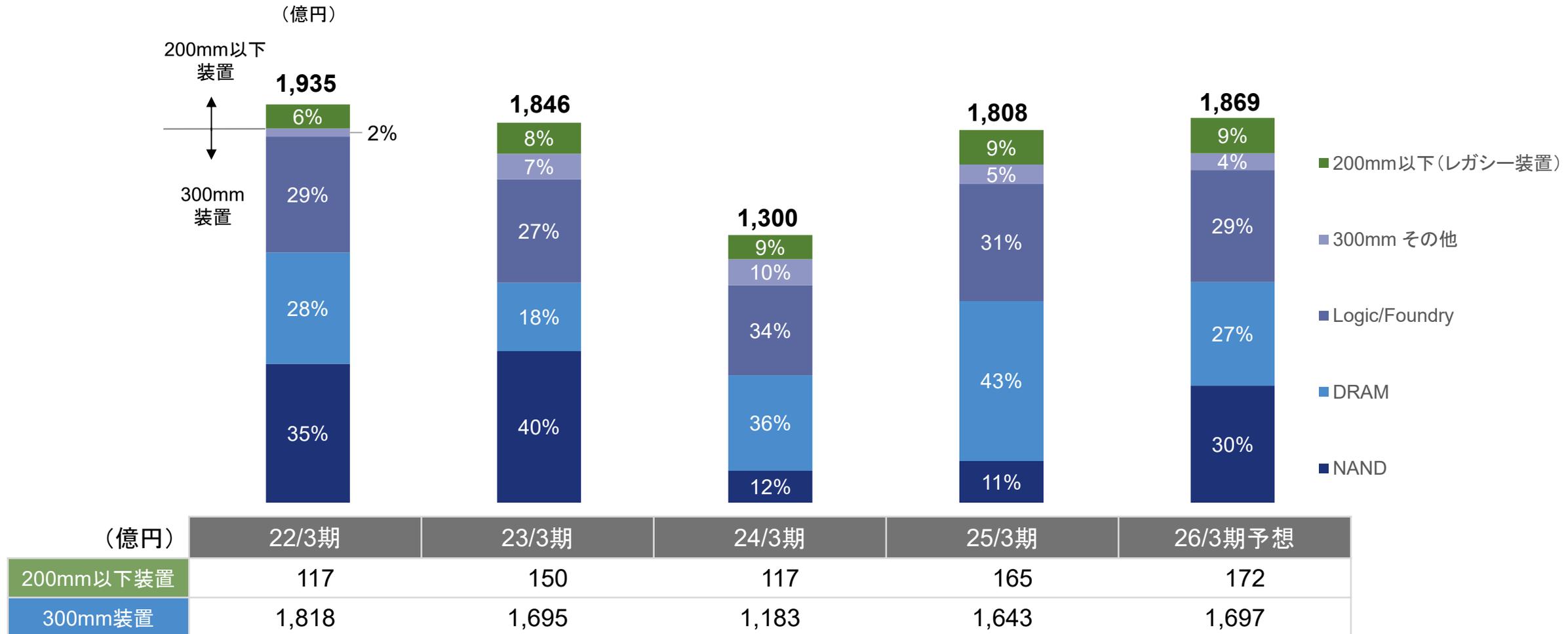
(億円)



| (億円) | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 | 26/3期予想 |
|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| サービス | 636 | 762 | 625 | 746 | 744 |
| 装置 | 1,818 | 1,695 | 1,183 | 1,643 | 1,697 |

2026年3月期業績予想 アプリケーション別売上収益*1(5月13日公表)

前期比でDRAM向けは35%減、Logic/Foundry向けは微減を見込む一方、NAND向けが2.8倍の伸長、SiC/GaNパワーデバイス向けは5割増を見込む。

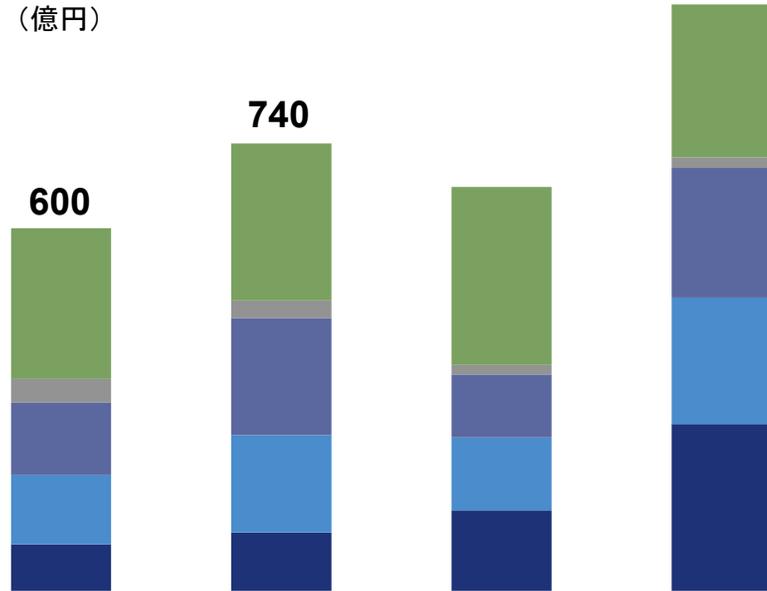


2026年3月期業績予想 上期・下期別売上収益 アカウント別*1 (5月13日公表)

上期(1Q)に中国地場向け出荷が集中した25/3期に対し、26/3期は下期(特に4Q)に世界各国向け出荷が集中する見通し。世界各国向けは上期・下期とも増収、中国地場向けは上期・下期とも減収を見込む。

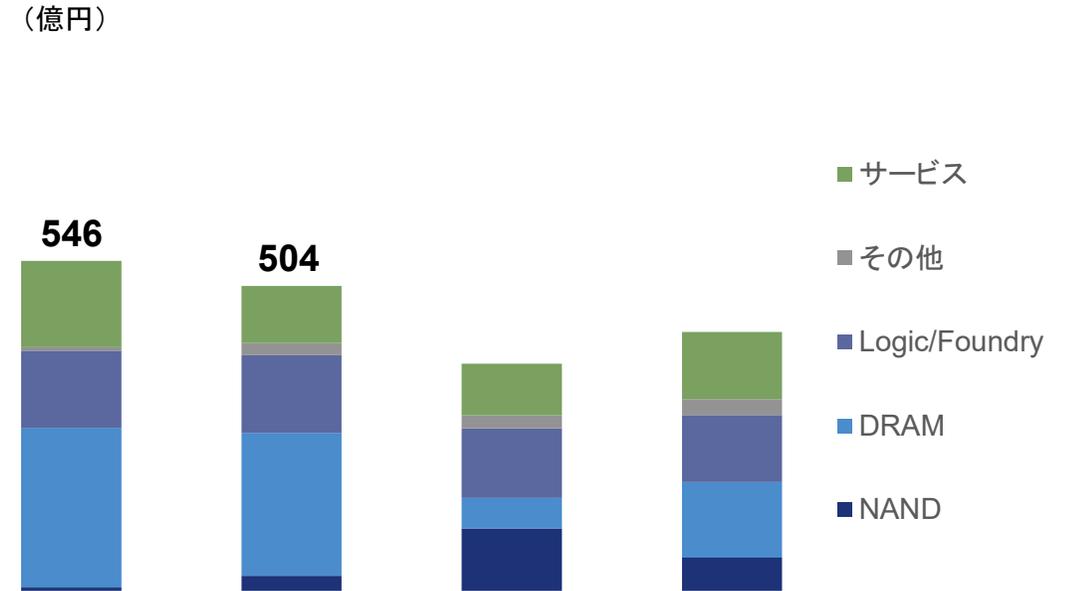
世界各国向け売上収益

(億円)



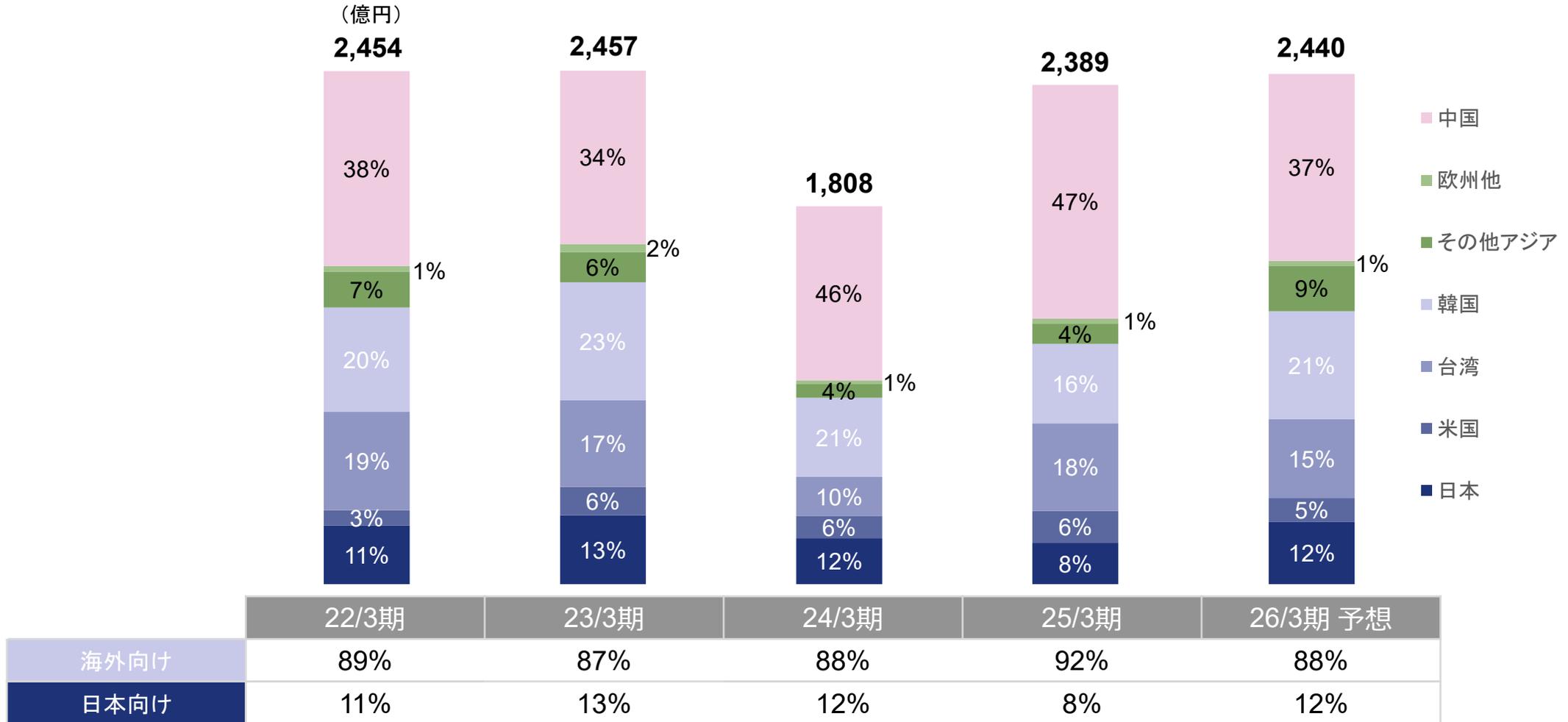
中国地場向け売上収益

(億円)



2026年3月期業績予想 仕向地別売上収益(5月13日公表)

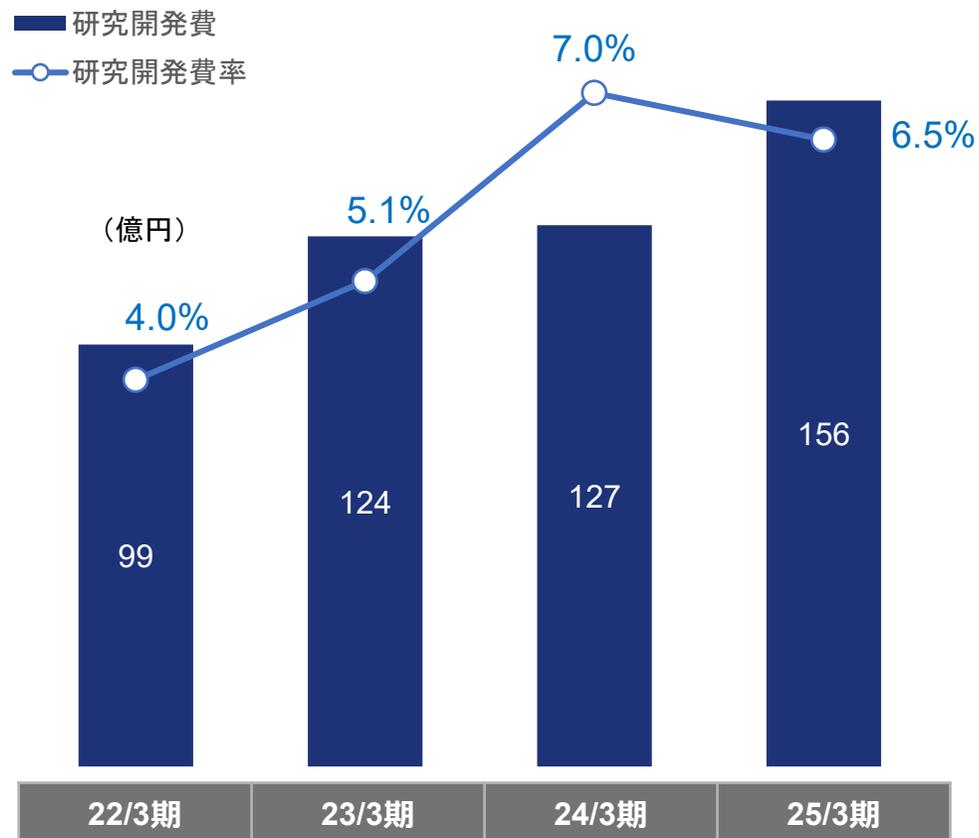
25/3期比で日本、韓国、その他アジア仕向け売上比率は増加、中国、台湾仕向け売上比率は減少の見通し。米国仕向け売上比率は5%にとどまる見通し。



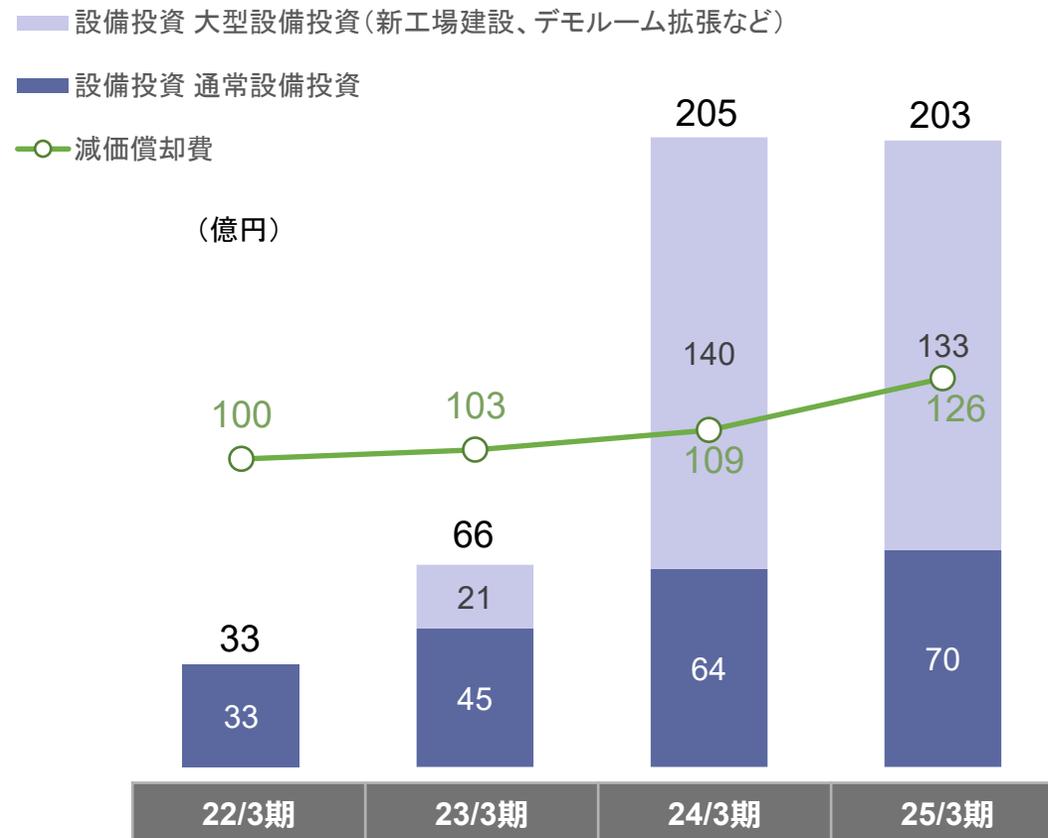
研究開発費／設備投資／減価償却費(5月13日公表)

中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。
 研究開発費は前期比2割増。設備投資は2年続いた大型設備投資が完了、減価償却費は前期比2割増。

研究開発費



設備投資／減価償却費

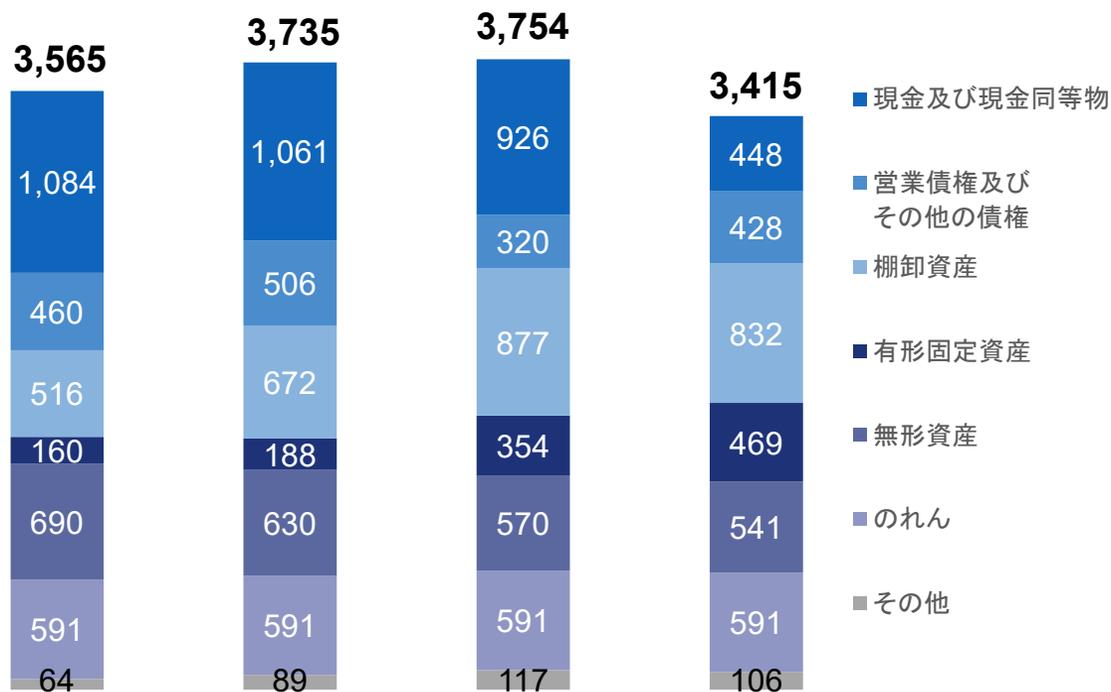


貸借対照表(5月13日公表)

資産合計は、借入金¹の期限前返済、自己株式の取得による現金等の減少により、前期末比で339億円減少。負債合計は、借入金¹の返済、営業債務等の減少により、前期末比で427億円減少。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で88億円増加。

資産

(億円)



22/3期末

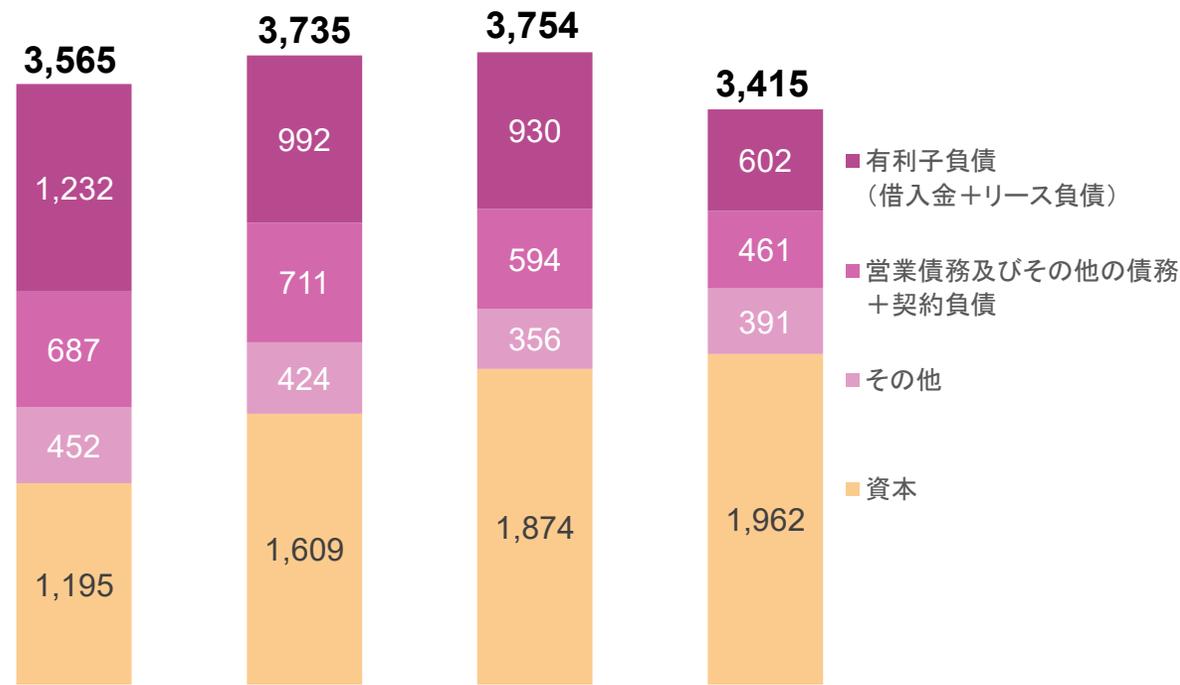
23/3期末

24/3期末

25/3期末

負債・資本

(億円)



22/3期末

23/3期末

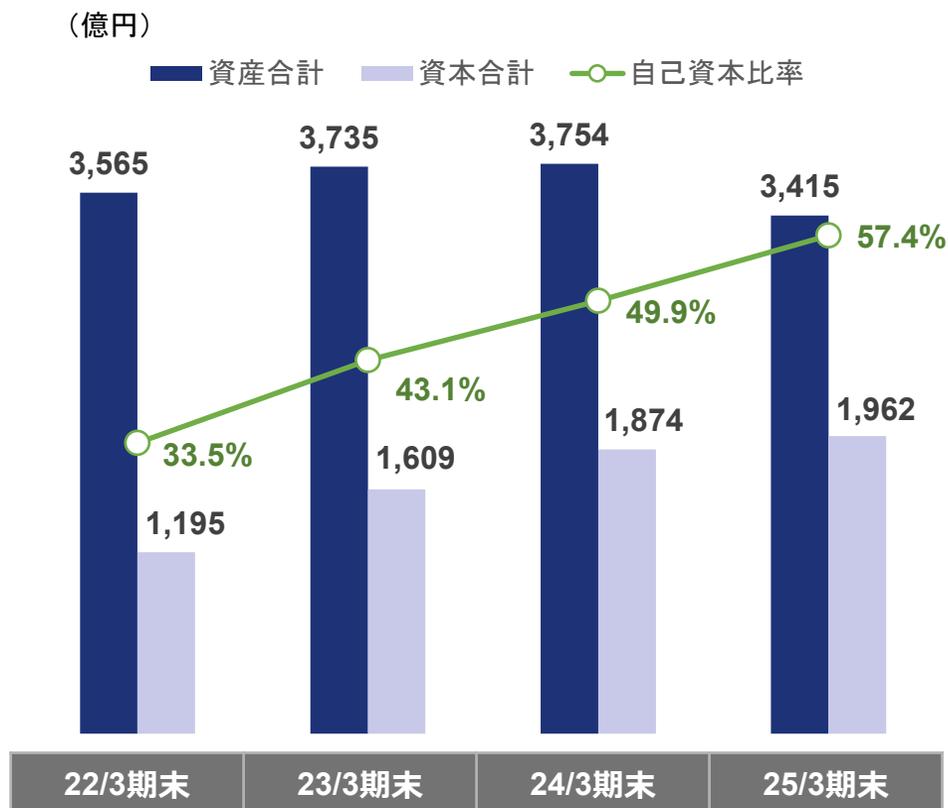
24/3期末

25/3期末

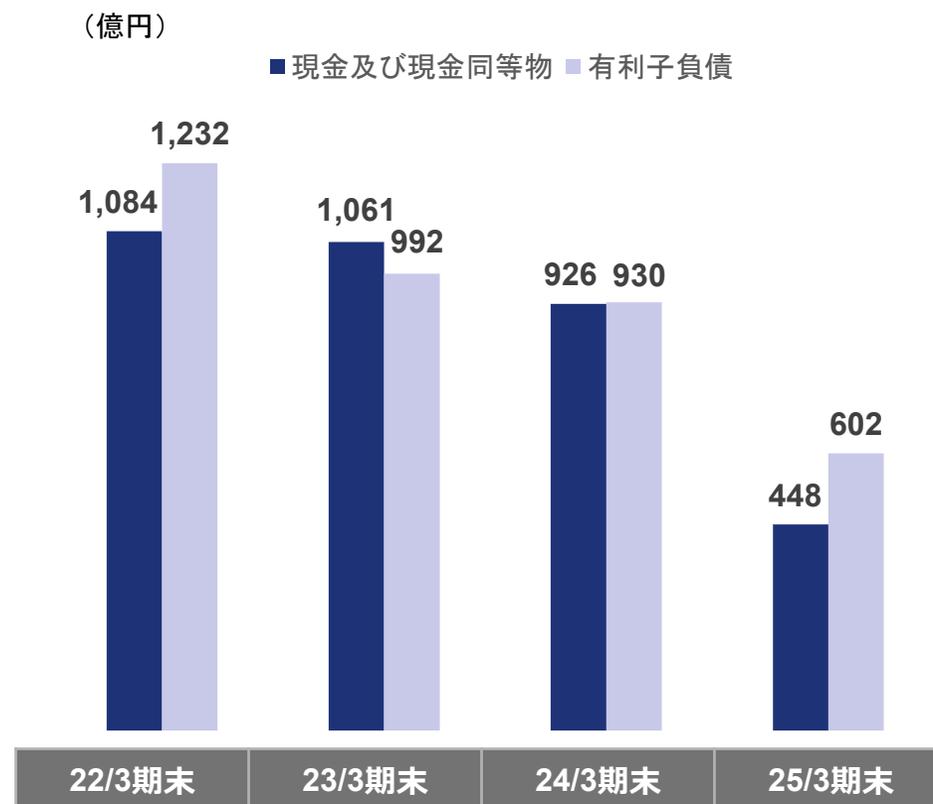
自己資本比率 & 現金及び現金同等物 / 有利子負債 (5月13日公表)

当期末の自己資本比率は57%に上昇。当期末のネットデットは自己株式の取得による現金の支出等で154億円に増加したものの、借入金は期限前返済により333億円減少。

資産合計 / 資本合計 / 自己資本比率

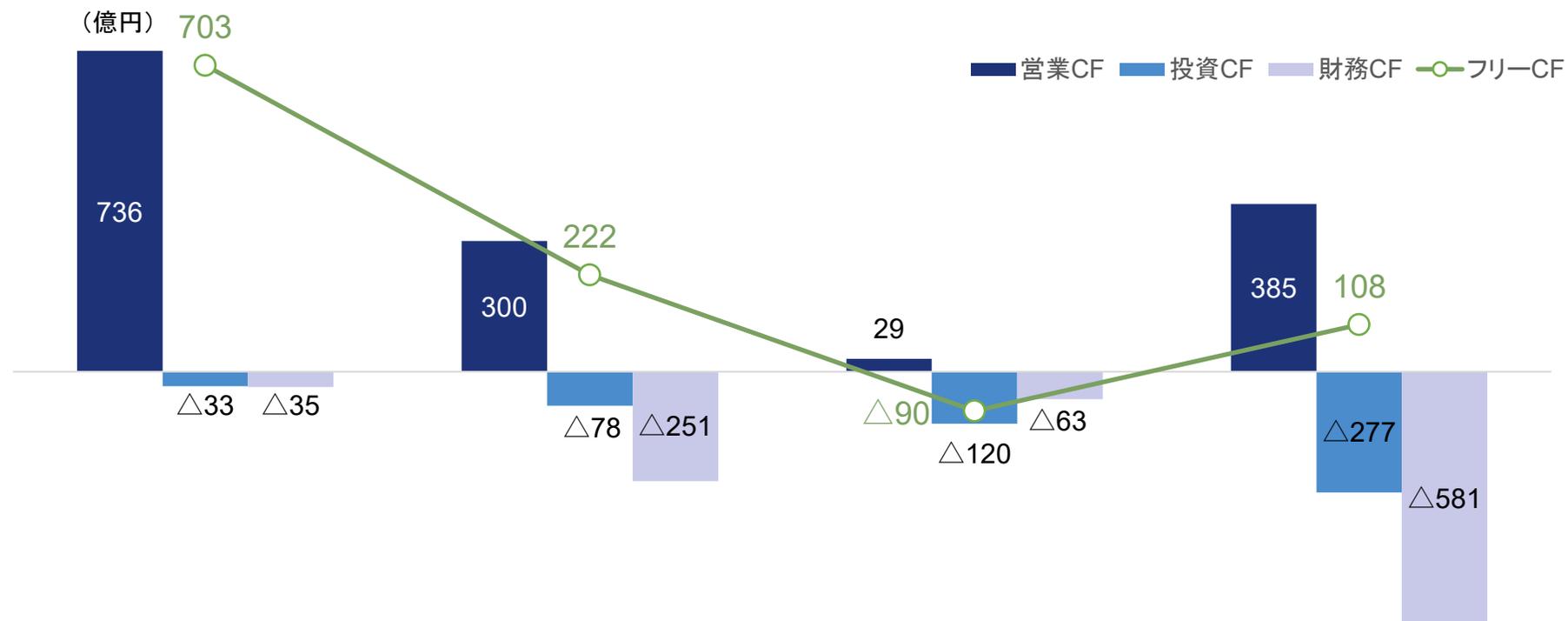


現金及び現金同等物 / 有利子負債



キャッシュ・フロー(5月13日公表)

売上収益増加による営業CFが有形固定資産取得による投資CFの支出を上回り、フリーCFは108億円。財務CFは借入金の期限前返済と自己株式の取得による支出等により、581億円の支出。

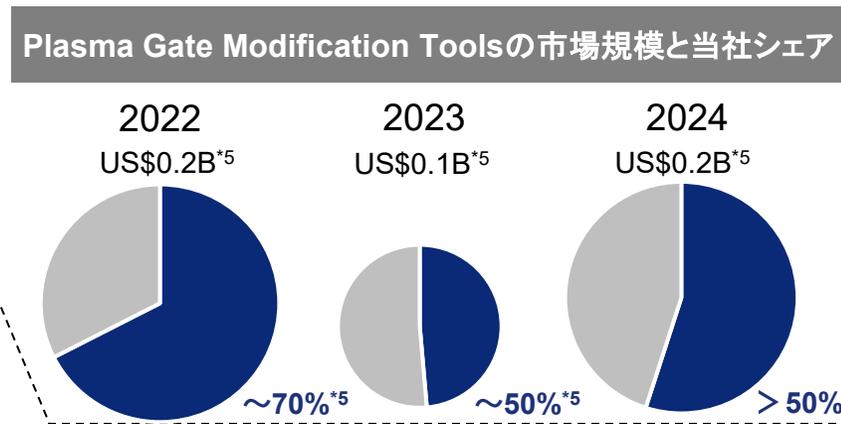
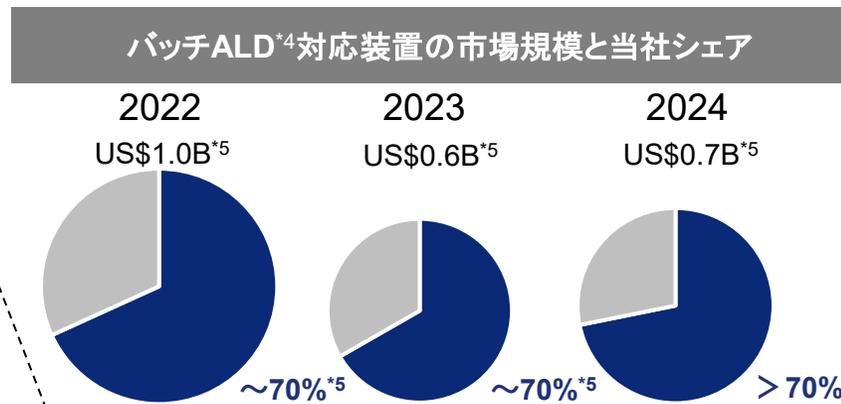
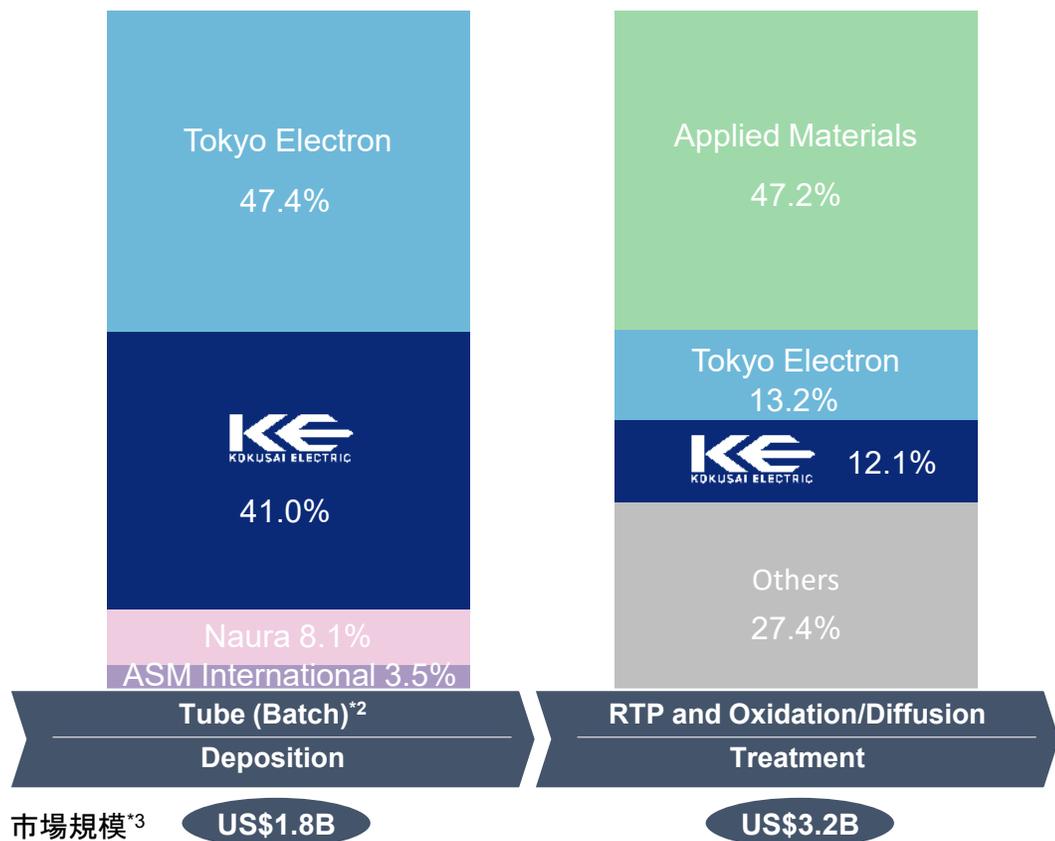


| (億円) | 22/3期 | 23/3期 | 24/3期 | 25/3期 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 営業CF | 736 | 300 | 29 | 385 |
| 投資CF | △33 | △78 | △120 | △277 |
| 財務CF | △35 | △251 | △63 | △581 |
| フリーCF | 703 | 222 | △90 | 108 |
| 現金及び現金同等物残高 | 1,084 | 1,061 | 926 | 448 |

マーケットシェアの推移(5月13日公表)

CY24は、CY23比でバッチ成膜装置、枚葉トリートメント装置ともシェア回復。
バッチALD^{*4}対応装置シェアは70%超で過去最高、枚葉トリートメント装置シェアは50%超に上昇。

(CY24) Gartnerの分類に基づく市場シェア^{*1}



^{*1} 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment(トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいつでも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。^{*2} GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義(当社にて算出) ^{*3} Gartnerによるカテゴリーの合計値 ^{*4} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます ^{*5} 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

用語集

- バッチ処理装置：多数のウェーハを一括処理する装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE : Wafer Fab Equipmentの略

